

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application: 2001年12月17日

出 願 番 号

Application Number: 特願2001-383069

[ST.10/C]:

[JP 2001-383069]

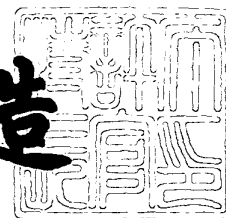
出 願 人

Applicant(s): 旭硝子株式会社

2002年 2月19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3009078

【書類名】 特許願

【整理番号】 AG2001-030

【提出日】 平成13年12月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C23C 14/54

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1 1 5 0 番地 旭硝子株式会社内

【氏名】 志堂寺 栄治

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1 1 5 0 番地 旭硝子株式会社内

【氏名】 安藤 英一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1 1 5 0 番地 旭硝子株式会社内

【氏名】 山田 朋広

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1 1 5 0 番地 旭硝子株式会社内

【氏名】 真下 尚洋

【特許出願人】

【識別番号】 000000044

【氏名又は名称】 旭硝子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083116

【弁理士】

【氏名又は名称】 松浦 憲三

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 31004

【出願日】 平成13年 2月 7日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001-220942

【出願日】 平成13年 7月23日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012678

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9005840

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スパッタ装置及びスパッタ成膜方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、

チャンバー壁の内側にはマグネトロンスパッタ源が配置され、

前記マグネトロンスパッタ源はターゲットと該ターゲットを保持するマグネロン部からなり、

前記ターゲットは前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネロン部により保持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置であって、該スパッタ装置は、

前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に測定する膜厚測定手段と、

前記ターゲットに対して、スパッタに必要な電力を供給する電源部と、

前記膜厚測定手段で得られる測定結果を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のスパッタ装置において、該スパッタ装置は、隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源と、

単一のマグネロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、を備えたことを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 3】 請求項 2 に記載のスパッタ装置において、

前記制御手段は、成膜開始から前記 AC 型マグネトロンスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記 AC 型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施するように制御することを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 4】 請求項 3 に記載のスパッタ装置において、前記制御手段は、前記低速成膜中に前記膜厚測定手段によって膜厚を監視し、膜厚が前記目標膜厚に到達したことが検出された時点で前記の単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源による成膜を中止する制御を行うことを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 5】 チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、

チャンバー壁の内側には、ターゲットと該ターゲットを保持するマグネトロン部からなるマグネトロンスパッタ源が配置され、前記ターゲットは前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネトロン部により保持された構造を有するカーセル型スパッタ装置であって、該スパッタ装置は、

隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源のみを前記マグネトロンスパッタ源として備えるとともに、

前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に前記ドラムを回転させながら測定する膜厚測定手段と、

前記ターゲットに対して、スパッタに必要な電力を供給する電源部と、

前記膜厚測定手段で得られる測定結果を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置において、該スパッタ装置は、

低屈折率膜の成膜に用いられるターゲットが取り付けられる低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源と、

高屈折率膜の成膜に用いられるターゲットが取り付けられる高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源と、が併設されていることを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 7】 前記膜厚測定手段は、前記基板に対して測定光を照射する投光手段と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、

その受光量に応じた電気信号を出力する受光手段と、を備え、前記ドラムの回転中に前記投光手段から前記基板に測定光を照射することにより、前記膜厚の測定を行うことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置。

【請求項 8】 前記受光手段から出力される受光信号に基づいて透過率情報または反射率情報を算出する演算手段、を備えたことを特徴とする請求項 7 に記載のスパッタ装置。

【請求項 9】 前記演算手段は、前記測定光の入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる信号に基づいて、入射角度に応じた透過率情報または反射率情報を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴とする請求項 8 に記載のスパッタ装置。

【請求項 10】 前記膜厚測定手段は、前記基板に対して波長の異なる複数種類の測定光を選択的に照射し得る投光手段と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、その受光量に応じた電気信号を出力する受光手段と、を備え、前記ドラムの回転中に前記投光手段から前記基板に測定光を照射することにより、前記膜厚の測定を行うことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置。

【請求項 11】 前記受光手段から出力される受光信号に基づいて、前記波長の異なる複数種類の測定光に対する透過率情報または反射率情報を算出する演算手段、を備えたことを特徴とする請求項 10 に記載のスパッタ装置。

【請求項 12】 前記演算手段は、前記波長の異なる複数種類の測定光に対して、それぞれ入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴とする請求項 11 に記載のスパッタ装置。

【請求項 13】 前記演算手段は、前記取得した入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータから近似変換を行って分光透過率または分光反射率を算出することを特徴とする請求項 9 または 12 に記載のスパッタ装置。

【請求項 14】 前記膜厚測定手段は、前記マグネトロンスパッタ源から離

れた位置に設置されることを特徴とする請求項 7 乃至 1 3 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置。

【請求項 1 5】 前記測定光の透過光又は反射光が通過する光路の周囲を包囲する遮光筒が前記チャンバーの内壁と前記基板ホルダーとの間に設けられていることを特徴とする請求項 7 乃至 1 4 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置。

【請求項 1 6】 前記遮光筒は、前記チャンバーと電氣的に絶縁されていることを特徴とする請求項 1 5 に記載のスパッタ装置。

【請求項 1 7】 前記遮光筒の先端部には、前記基板との間の多重反射を低減する反射防止部材が取り付けられていることを特徴とする請求項 1 5 又は 1 6 に記載のスパッタ装置。

【請求項 1 8】 隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源と、

単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、

成膜開始から前記 AC 型マグネトロンスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記 AC 型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施するように制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とするスパッタ装置。

【請求項 1 9】 前記ターゲットは、前記基板と対向する位置関係になったときに、前記基板に対面するターゲット面が基板面に対して平行とならないように前記ターゲット面が所定の傾斜角度を有していることを特徴とする請求項 1 乃至 1 8 の何れか 1 項に記載のスパッタ装置。

【請求項 2 0】 チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、チャンパー壁の内側にはマグネトロンスパッタ源が配置され、前記マグネトロンスパッタ源はターゲットと該ターゲットを保持するマグネトロン部からなり、前記ターゲットは、前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネトロン部により保

持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置を用いて成膜を行うスパッタ成膜方法であって、該方法は、

前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に測定する膜厚測定工程と、

前記膜厚測定工程で得られた測定結果の情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御工程と、

を含むことを特徴とするスパッタ成膜方法。

【請求項 2 1】 隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、を有したスパッタ装置を用いて成膜を行うスパッタ成膜方法であって、該方法は、

成膜開始から前記 AC 型マグネトロンスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記 AC 型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施することを特徴とするスパッタ成膜方法。

【請求項 2 2】 請求項 2 1 に記載のスパッタ成膜方法において、成膜中に膜厚を測定する膜厚測定工程と、前記測定で得た情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御工程とを含むことを特徴とするスパッタ成膜方法。

【請求項 2 3】 チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、チャンバー壁の内側には、ターゲットと該ターゲットを保持するマグネトロン部からなるマグネトロンスパッタ源が配置され、前記ターゲットは、前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネトロン部により保持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置を用いて成膜を行うスパッタ成膜方法であって、該方法は、

前記マグネトロンスパッタ源として、隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源のみを利用し、前記ドラムを回転させながら、前記基板ホルダーに取

り付けられている基板上に膜を形成する成膜工程と、

前記基板上に形成される膜の膜厚を前記成膜工程における前記ドラムの回転中に測定する膜厚測定工程と、

前記膜厚測定工程で得られた測定結果の情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御工程と、

を含むことを特徴とするスパッタ成膜方法。

【請求項 2 4】 前記膜厚測定工程は、前記ドラムを回転させながら前記基板に対して測定光を照射する投光工程と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、その受光量に応じた電気信号を出力する受光工程と、を含むことを特徴とする請求項 2 0、2 2 または 2 3 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 2 5】 前記受光工程により出力される受光信号に基づいて透過率情報または反射率情報を算出する演算工程を含むことを特徴とする請求項 2 4 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 2 6】 前記演算工程は、前記測定光の入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光工程で得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴とする請求項 2 5 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 2 7】 前記膜厚測定工程は、前記ドラムを回転させながら前記基板に対して波長の異なる複数種類の測定光を選択的に照射する投光工程と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、その受光量に応じた電気信号を出力する受光工程と、を含むことを特徴とする請求項 2 0、2 2 又は 2 3 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 2 8】 前記受光工程で得られる受光信号に基づいて、前記波長の異なる複数種類の測定光に対する透過率または反射率を算出する演算工程を含むことを特徴とする請求項 2 7 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 2 9】 前記演算工程は、前記波長の異なる複数種類の測定光に対して、それぞれ入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記

受光工程で得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴とする請求項 2 8 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 3 0】 前記演算工程は、前記取得した入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータから近似変換を行って分光透過率または分光反射率を算出することを特徴とする請求項 2 6 または 2 9 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 3 1】 前記膜厚の測定において、前記マグネトロン部で発生するプラズマ光の影響を小さくするように、前記膜厚の測定は、前記マグネトロン部から離れた場所で行うことを特徴とする請求項 2 0 及び 2 2 乃至 3 0 の何れか 1 項に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 3 2】 前記測定光の透過光又は反射光が通過する光路の周囲を遮光筒によって包囲し、外部からの不要光の影響を小さくしてノイズの低減を図ることを特徴とする請求項 2 4 乃至請求項 3 1 に記載のスパッタ成膜方法。

【請求項 3 3】 請求項 2 0 乃至 3 2 の何れか 1 項に記載のスパッタ成膜方法において、前記ターゲットが前記基板と対向する位置関係になったときに、前記基板に対面するターゲット面が基板面に対して平行とならないように前記ターゲット面が傾斜面で構成されたターゲットを用いることを特徴とするスパッタ成膜方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学フィルター等の成膜工程に適用されるスパッタ装置及びスパッタ成膜方法に係り、特に、WDM (Wavelength Division Multiplexing: 波長多重分割) 技術で用いられるWDM用フィルターの製造に好適なスパッタ装置及びスパッタ成膜方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

特開平 3 - 2 5 3 5 6 8 号公報には、ガラス板などの基板に成膜を行うためのカルーセル型スパッタ装置が開示されている。カルーセル型スパッタ装置は、回

転・パッチ型のスパッタ装置であり、チャンバー内に多角柱形の基板ホルダー（回転ドラム）が配置されるとともに、チャンバー壁内側に矩形ターゲットを保持するマグネトロンが設置された構造を有している。基板を取り付けた基板ホルダーを回転させながらマグネトロンの電力を投入し、ターゲット上面にプラズマを発生させるとともに、所定の反応ガスをチャンバー内に導入することによって成膜が行われる。

【0003】

また、特開平11-241162号公報によれば、成膜中の膜厚を光学的測定手段によって連続的にモニタするスパッタリング方法が提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

近時、光ファイバー通信の分野で注目されているWDM技術で用いられるWDM用フィルターは、低屈折率材料の膜（例えば SiO_2 膜）と高屈折率材料の膜（例えば Ta_2O_5 膜）を交互に組み合わせ、極めて多くの層（例えば、100層程度）を積層して形成される。かかる光学多層膜の製造に際しては、各層の膜厚を設計値通り正確に形成することが重要であり、高速かつ高精度に成膜を行うための技術の開発が望まれている。

【0005】

図27は、従来の光学多層膜成膜用のスパッタ装置の概略図である。略円筒形のチャンバー200内に多角筒形の基板ホルダー202が配置され、基板ホルダー202の各側面に基板204が取り付けられる。チャンバー壁内側には、低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源206と、高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源208が設置され、前者には低屈折率膜形成用のターゲット（例えば Si ターゲット）210が取り付けられ、後者には高屈折率膜形成用のターゲット（例えば、 Ti ターゲット）212が取り付けられる。

【0006】

基板ホルダー202は、中心軸214を回転中心として回転しており、スパッタ電源216からマグネトロンスパッタ源206に電力を供給することによって、ターゲット210上面付近にプラズマが発生し、図示せぬガス導入部から供給

されるガスと反応してターゲット210前を通過する各基板204上に低屈折率膜が形成される。同様に、スパッタ電源218からマグネトロンスパッタ源208に電力を供給することによって、ターゲット212上面にプラズマが発生し、導入されたガスと反応して各基板204上に高屈折率膜が形成される。スパッタ電源216、218の投入時間と成膜量の関係（成膜速度）を予め調査しておき、スパッタ時間を管理しながら、各マグネトロンスパッタ源206、208に対して交互に電源供給を行うことによって所望の多層膜を形成する。

【0007】

しかしながら、上記従来の成膜装置は、高精度の膜厚管理が困難であり、膜厚精度を高めるためには、成膜速度を遅くして対応しなければならず、生産性が著しく低下するという問題がある。

【0008】

特開昭49-115085号公報は、カルーセル型スパッタ装置に関する記載は無いが、成膜工程においてスパッタ装置へのエネルギー供給を断続的に行い、エネルギーの断期間（供給休止期間）に膜厚を測定して、その結果をエネルギー供給系にフィードバックする方法が提案されている。しかし、この方法は、成膜工程と測定工程が交互に行われ、測定中は成膜が中断されるため、生産性が悪いという欠点がある。

【0009】

また、特開平3-253568号公報のように、二つのカソードと該カソードに電力を印加するための二つの電源とを用いたスパッタ装置（方法）によって膜厚の均一化を図る場合では、二つのカソードが対で成膜に寄与するため、成膜速度に影響する要因（磁場、印加電圧、ターゲット表面の状態、ガス圧等）について二つのカソード間で差を小さくすることが必要となる。しかし、二つのカソードについて条件を合わせることは困難であり、結果として膜厚の均一化の制御は容易ではない。

【0010】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、膜厚を高精度で制御でき、生産性に優れるスパッタ装置及びスパッタ成膜方法を提供することを目的とする。

。また、従来に比べてより簡単に膜厚の均一化を達成できるとともに、装置の小型化並びに低コスト化を実現できるスパッタ装置及びスパッタ成膜方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために請求項 1 に記載の発明は、チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、チャンバー壁の内側にはマグネトロンスパッタ源が配置され、前記マグネトロンスパッタ源はターゲットと該ターゲットを保持するマグネトロン部からなり、前記ターゲットは前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネトロン部により保持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置であって、該スパッタ装置は、前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に測定する膜厚測定手段と、前記ターゲットに対して、スパッタに必要な電力を供給する電源部と、前記膜厚測定手段で得られる測定結果を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御手段と、を備えたことを特徴としている。

【 0 0 1 2 】

本発明によれば、カルーセル型スパッタ装置において成膜中に膜厚をモニタリングし、その情報を制御系にフィードバックして、コントロールすることができる。成膜量に影響するパラメータの制御としては、スパッタ電源の電力制御の他、基板ホルダー（ドラム）の回転速度、シャッター開閉度、スパッタ圧力等の制御がある。例えば、成膜を停止する場合は、スパッタ電源の電力を止める、またはシャッターを閉めるなどを行う。

【 0 0 1 3 】

本発明の一態様として、請求項 2 に記載のスパッタ装置は、隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、を備えたことを特徴している。

【 0 0 1 4 】

「単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源」としては、DC（直流）型マグネトロンスパッタ源の他に、RF（高周波）型マグネトロンスパッタ源、パルス（直流電圧を一定の時間間隔で印加する）型マグネトロンスパッタ源などがある。

【0015】

AC型マグネトロンスパッタ源は、単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源よりも高速成膜が可能である。本発明は、これら二種類のスパッタ源を併用して、高速かつ高精度の成膜を実現したものである。

【0016】

この場合、請求項3に示したように、成膜開始から前記AC型マグネトロンスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記AC型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施するように制御する態様がある。これにより、高精度の膜厚コントロールを行うことができる。

【0017】

更に、請求項4に示したように、前記低速成膜中に前記膜厚測定手段によって膜厚を監視し、膜厚が前記目標膜厚に到達したことが検出された時点で前記の単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源による成膜を中止する制御を行う態様が好ましい。なお、通常は、成膜中に膜厚を常時監視する。

【0018】

単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源のみを使用して低速成膜を行っている期間中、膜厚をモニタリングし、その情報を制御系にフィードバックすることにより、膜厚をより高精度にコントロールできる。

【0019】

請求項5に記載の発明は、チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状の

ドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、チャンバー壁の内側には、ターゲットと該ターゲットを保持するマグネトロン部からなるマグネトロンスパッタ源が配置され、前記ターゲットは前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネトロン部により保持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置であって、該スパッタ装置は、隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替えるＡＣ型マグネトロンスパッタ源のみを前記マグネトロンスパッタ源として備えるとともに、前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に前記ドラムを回転させながら測定する膜厚測定手段と、前記ターゲットに対して、スパッタに必要な電力を供給する電源部と、前記膜厚測定手段で得られる測定結果を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御手段と、を備えたことを特徴としている。

【 0 0 2 0 】

膜厚誤差が１％のオーダーで要求される積層膜を形成する場合には、高速のＡＣ型マグネトロンのみを使用して要求を満たす膜を形成することができる。

【 0 0 2 1 】

ＷＤＭ用フィルター等の製造に利用される光学多層膜成膜装置などのように、低屈折率膜と高屈折率膜を交互に成膜するための装置に本発明を適用する場合は、請求項６に示したように、低屈折率膜の成膜に用いられるターゲットが取り付けられる低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源と、高屈折率膜の成膜に用いられるターゲットが取り付けられる高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源と、が併設された構造を有するスパッタ装置を用いる。

【 0 0 2 2 】

低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源と、高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源の各スパッタ源について、それぞれＡＣ型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネトロン部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源との組み合わせによって構成することにより、低屈折率膜の成膜工程及び高屈折率膜の成膜工程において、高速成膜と高精度の成膜制御が実現できる。

【 0 0 2 3 】

もちろん、要求される膜厚精度によってはAC型マグネトロンのみを使用して成膜を行う態様も可能である。

【0024】

請求項7に記載の態様によれば、前記膜厚測定手段は、前記基板に対して測定光を照射する投光手段と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、その受光量に応じた電気信号を出力する受光手段と、を備え、前記ドラムの回転中に前記投光手段から前記基板に測定光を照射することにより、前記膜厚の測定を行うことを特徴としている。

【0025】

本態様に係る膜厚測定手段は、膜厚を直接測定するのではなく、間接的な情報を測定する。すなわち、膜厚測定手段は、投光手段と受光手段とからなり、受光手段は、受光した光量に応じた電気信号を出力する。測定光には、例えば、550nmの単色の測定光や、それより波長の短い549nmの単色の測定光を用いる。投光手段から単色の測定光を投射する態様に限らず、白色の（波長選択していない）測定光を投光手段から投射し、受光側で単色化する態様もある。

【0026】

請求項8に示したように、受光手段から出力された電気信号（受光信号）は演算手段に送られ、演算手段によって透過率情報または反射率情報に演算される。演算手段は、必要に応じて膜厚測定手段に内包されてもよいし、制御手段に含まれてもよい。

【0027】

請求項9に記載の態様によれば、前記演算手段は、前記測定光の入射角度が0°及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴としている。

【0028】

カルーセル型スパッタ装置においては基板ホルダーが回転しているために、膜厚測定用の投光手段と受光手段が所定の位置に固定設置されている場合、測定光の入射角度が常に変化する。垂直入射時（入射角度0°）とその前後を含む所定

の角度範囲における 1 又は複数のポイントの受光信号を演算し、透過率または反射率の入射角度に対する依存性を求める。

【 0 0 2 9 】

こうして得られた入射角度と透過率または反射率の関係を示すプロファイル（入射角度に対する透過率または反射率の変化を示す曲線）を利用することにより、成膜の終点などを確実に決定することができる。例えば、演算されるプロファイルと目標とする光学特性を有する製品の既存のプロファイルと比較したり、リアルタイムで演算されるプロファイルの形状変化を追跡するなどの手法によって成膜の終点を決定することができる。

【 0 0 3 0 】

また、本発明の他の態様として、請求項 1 0 に示したように、前記膜厚測定手段は、前記基板に対して波長の異なる複数種類の測定光を選択的に照射し得る投光手段と、前記基板に照射された前記測定光の透過光または反射光を受光して、その受光量に応じた電気信号に変換する受光手段と、を備え、前記ドラムの回転中に前記投光手段から前記基板に測定光を照射することにより、前記膜厚の測定を行うことを特徴とする態様がある。例えば、5 5 0 n m と 5 4 9 n m の測定光を選択的に切り替えて使用する。

【 0 0 3 1 】

請求項 1 1 に示したように、受光手段から出力された電気信号（受光信号）は演算手段に送られ、演算手段によって前記波長の異なる複数種類の測定光に対する透過率情報または反射率情報に演算される。

【 0 0 3 2 】

請求項 1 2 に記載の態様によれば、前記演算手段は、前記波長の異なる複数種類の測定光に対して、それぞれ入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得することを特徴としている。

【 0 0 3 3 】

更に、請求項 1 3 に示すように、前記演算手段は、前記取得した入射角度と透

過率または反射率の関係を示すデータから近似変換を行って分光透過率または分光反射率を算出する態様がある。

【 0 0 3 4 】

所定の角度範囲について得られた透過率または反射率のデータに基づき、角度を波長に換算して近似値を得る演算手法によって、当該測定波長よりも長波長側の分光透過率または分光反射率を求めることができる。波長の異なる複数種類の測定光を用いて透過率または反射率を測定することにより、一層精度の高い測定が可能となる。

【 0 0 3 5 】

また、上記した本発明のスパッタ装置において、所定波長の単色の測定光を用いてその入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータを取得してこれをグラフ化する第1の測定機能と、前記取得した入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータの平均値を算出する第2の測定機能と、前記取得した入射角度と透過率または反射率の関係を示すデータから近似変換を行って分光透過率または分光反射率を算出する第3の測定機能と、前記所定波長よりも短波長側の測定光を用いてその入射角度が 0° 及びその近傍を含む所定の角度範囲のときに前記受光手段から得られる受光信号に基づいて、入射角度に応じた透過率または反射率を求め、入射角度に対する透過率または反射率の関係を示すデータを取得し、当該取得した入射角度に対する透過率または反射率の関係を示すデータから近似変換を行って分光透過率または分光反射率を算出する第4の測定機能と、を備え、前記第1乃至第4の測定機能のうち、利用される測定機能またはその組み合わせが成膜工程の段階に応じて切り替えられるように構成する態様も好ましい。

【 0 0 3 6 】

光学多層膜を製造する場合、成膜過程の段階に応じて膜の光学的な性質が変化するため、それぞれの段階に適した測定方法を用いることにより、測定精度と膜厚制御の精度向上を図ることができる。

【 0 0 3 7 】

請求項 1 4 に示した様態によれば、前記膜厚測定手段は、前記マグネトロンスパッタ源から離れた位置に設置されることを特徴としている。「離れた位置」とは、「受光手段に最も近いマグネトロンの中心線（マグネトロンの中心を通り、ターゲット支持面に垂直な線）とチャンバー外壁との交点を基準として、外壁面上の周長に沿って水平方向に 1 5.0 mm 以上特に 9 0 0 mm 以上離れた位置」をいう。測定部を成膜空間から離すことにより、プラズマ光に起因するノイズを低減することができ、精度の良い測定が可能となる。

【 0 0 3 8 】

更に、請求項 1 5 に示したように、前記測定光の透過光又は反射光が通過する光路の周囲を包囲する遮光筒（遮光性のある筒状体）を付加することにより、成膜空間からのプラズマの迷光を遮断できる。この場合、請求項 1 6 に示したように、前記チャンバーと前記遮光筒を電氣的に絶縁し、フローティングポテンシャルとすることが好ましい。また、請求項 1 7 に示したように、前記遮光筒の先端部に、前記基板との間の多重反射による迷光の影響を低減する反射防止部材を取り付ける態様も好ましい。

【 0 0 3 9 】

かかる態様によって、成膜空間からのプラズマ光に起因するノイズを大幅に低減でき、精度のよい測定が可能となる。

【 0 0 4 0 】

請求項 1 8 に係るスパッタ装置は、隣接して配置された二つのターゲットのアニード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える AC 型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネatronスパッタ源と、成膜開始から前記 AC 型マグネatronスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記 AC 型マグネatronスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネatronスパッタ源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施するように制御する制御手段と、を備えたことを特徴としている。

【 0 0 4 1 】

本発明は、AC型マグネトロンスパッタ源と単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、を併用して高速成膜を実現するとともに、高精度の膜厚コントロールを可能にするものであり、特に、カルーセル型スパッタ装置に適用されることが好ましい。

【0042】

本発明の更に他の態様として、請求項19に記載のスパッタ装置によれば、前記ターゲットは、前記基板と対向する位置関係になったときに、前記基板に対面するターゲット面が基板面に対して平行とならないように前記ターゲット面が所定の傾斜角度を有していることを特徴としている。

【0043】

「対向する位置関係」とは、基板ホルダーの基板支持面の中心点と、該基板支持面から見たマグネatron部の中心点との距離が最小となったときを意味する。なお、AC型マグネトロンスパッタ源の場合は、隣接して配置される二つのターゲットの中心点（二つのターゲットを全体として一つのマグネatron部と見なしたときの中心点）を「マグネatron部の中心点」と解釈する。

【0044】

傾斜角度は、ターゲットが装着されるスパッタ装置の構成条件によって最適な角度に設計される。すなわち、膜厚が均一になる角度範囲でターゲット面を傾斜させる。かかる傾斜形のターゲットを用いることにより、スパッタ原子の飛散方向が調整されるとともに、回転する基板とターゲット間の距離と角度の関係等の諸条件が調整され、基板の進行方向についての膜厚の均一化を実現できる。もちろん、一つのカルーセル型スパッタ装置内において従来の平板形のターゲット（通常ターゲット）と本発明の傾斜形のターゲットとが混在する態様も可能である。

【0045】

請求項20に記載の発明は、請求項1に係る装置発明に対応する方法発明を提供する。すなわち、請求項20に係る方法は、チャンバー内に、横断面が多角形状または円形状のドラムが回転自在に設置され、該ドラムの外周面上に基板ホルダーが設けられ、チャンバー壁の内側にはマグネトロンスパッタ源が配置され、

マグネトロンスパッタ源はターゲットと該ターゲットを保持するマグネatron部からなり、前記ターゲットは、前記ドラムの回転軸と平行となるように前記マグネatron部により保持された構造を有するカルーセル型スパッタ装置を用いて成膜を行うスパッタ成膜方法であって、該方法は、前記基板ホルダーに取り付けられる基板上に形成される膜の膜厚を成膜中に測定する膜厚測定工程と、前記膜厚測定工程で得られた測定結果の情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する制御工程と、を含むことを特徴としている。

【0046】

請求項21に記載の発明は、請求項18に係る装置発明に対応する方法発明を提供する。すなわち、請求項21に係る方法は、隣接して配置された二つのターゲットのアノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替えるAC型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源と、を有したスパッタ装置を用いて成膜を行うスパッタ成膜方法であって、該方法は、成膜開始から前記AC型マグネトロンスパッタ源を利用した高速成膜を実行して目標膜厚の手前一定量まで成膜した後に、前記AC型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、前記の単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネatron源のみを利用した低速成膜に切り替えて前記目標膜厚までの成膜を実施することを特徴としている。

【0047】

この場合、請求項22に示したように、成膜中に膜厚を測定し、前記測定で得た情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御する態様が好ましい。

【0048】

請求項23乃至32に記載の発明はそれぞれ請求項5及び7乃至15に係る装置発明に対応する方法発明を提供するものであり、請求項33に記載の発明は請求項19に係る装置発明に対応する方法発明を提供するものである。

【0049】

【発明の実施の形態】

以下添付図面に従って本発明のスパッタ装置及びスパッタ成膜方法の好ましい実施の形態について説明する。

【0050】

図1は本発明の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置の構成を示す平面模式図であり、図2は本装置で使用される基板ホルダーの斜視図である。図1に示したスパッタ装置10は、高さ2m、直径1.5mの円筒形チャンバー12内に、ドラム（図1中不図示、図2中符号17）と該ドラム17の外周面上に設けられた基板ホルダー14とを有し、直径1mの正十二角形を構成する各基板ホルダー14がドラム17の中心軸16を回転中心として回転可能に支持された構造から成るカルーセル型のスパッタ装置である。

【0051】

反応室となるチャンバー12は、図示せぬ排気用ポンプと連結され、スパッタに必要な低圧を得ることができる。また、図示されていないが、チャンバー12には、スパッタに必要なガスを導入するためのガス供給手段やローディング用ドアが設けられている。なお、チャンバー12の内壁は、ドラム17と概略所定間隔をもって対向する形状（内周形状）を有している。

【0052】

図2に示すように、基板ホルダー14は、円筒形状のドラム17の外周面に取り付けられており、回転自在に設置されたドラム17と一体的に回転する。なお、ドラム17の形状は円筒形状に限らず、多角筒形状（横断面が多角形状）等であってもよい。

【0053】

図1に示したように、基板ホルダー14には成膜用の基板（例えば、ガラス基板）18が取り付けられ、基板ホルダー14は、図示せぬ回転駆動装置によるドラム17の回転に伴って一定の回転速度（例えば、6rpm）で回転する。チャンバー12の内側には、低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源20と、高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源30とがそれぞれ設置されている。これらマグネトロンスパッタ源20、30は、高さ方向の長さが1.2mの矩形型マグネトロンスパッタ源であり、マグネトロンスパッタ源20または30の前を基板18が通過することによって成膜が行われる。

【0054】

マグネトロンスパッタ源 20 は、単一のマグネatron部 21 に対して電源（本例では、矩形波状のパルス電力を供給する DC 電源）22 が接続された従来型のマグネatronスパッタ源（以下、通常のマグネatronという。）23 と、二つのマグネatron部 24、25 に対して一つの交流電源 26 が接続され、アノード／カソードの関係を所定周波数で交互に切り替える交流型マグネatronスパッタ源（以下、AC のマグネatronという。）27 との組み合わせによって構成される。

【0055】

同様に、マグネatronスパッタ源 30 は、単一のマグネatron部 31 に対して電源 32 が接続された通常のマグネatron 33 と、二つのマグネatron部 34、35 に対して一つの交流電源 36 が接続された AC のマグネatron 37 との組み合わせによって構成される。

【0056】

AC のマグネatron 27、37 の動作原理は、特開平 5-222530 号、特開平 5-222531 号、特開平 6-212421 号、特開平 10-130830 号の各公報に開示されている。概説すると、AC のマグネatron とは、ターゲットを二個並べて配置し、一方のターゲットがカソードの時は、他方がアノードとなり、数十 kHz の周波数でカソードとアノードが入れ替わるマグネatron 装置であり、種々の制御を行うことにより、安定かつ高速に酸化物膜や窒化物膜等を成膜することができる。

【0057】

通常のマグネatron 23、33 は、AC のマグネatron 27、37 に比べて成膜スピードが低速である反面、膜厚を精度良く制御できるという利点がある。図 1 に示したスパッタ装置 10 は、高速成膜可能な AC のマグネatron 27、37 と、高精度の膜厚制御が可能な通常のマグネatron 23、33 を組み合わせて使用することにより、高速成膜と高精度の膜厚制御を実現している。

【0058】

また、スパッタ装置 10 は、成膜中に膜厚を測定する手段（膜厚モニタリングシステム）として、ハロゲンランプ 40、モノクロメータ 41、光ファイバー 4

2、投光ヘッド44、受光ヘッド46、受光処理部48を備えている。ハロゲンランプ40からの光は、モノクロメータ41によって波長選択された後、光ファイバー42を介して投光ヘッド44に導かれる。投光ヘッド44は、基板ホルダー14の内側（ドラム17の内側）に設置され、投光ヘッド44から回転中の基板18に向けて光が照射される。図28に示したように、基板ホルダー14の縦方向中央部には回転方向に長い光通過用の開口（測定用穴）14Aが形成されている。測定用穴14Aの縦方向の長さは投射光のスポット直径と略同程度の大きさ（本例では30mm）に形成されており、この測定用穴14Aを通してモニタ対象基板18Aに光が照射される。測定用穴14Aの長手方向の幅が大きい程、測定光の入射角度範囲を広くすることができる。なお、図29に示すように、測定用穴14Aの部分に膜厚測定専用のモニタ対象基板18Bを取り付けて、膜厚を測定する態様も可能である。

【0059】

図1に示したチャンバー12の外側には、受光ヘッド46が設置されており、チャンバー12の外壁には受光ヘッド46に光を導く窓部（不図示）が設けられている。基板18を透過した光は、受光ヘッド46で受光され、受光量に応じた電気信号に変換された後、受光処理部48に送られる。受光処理部48は、受入した信号に対して所定の信号処理を行い、コンピュータ入力用の測定データに変換する。受光処理部48で処理された測定データは、パーソナルコンピュータ（以下、パソコンという。）50に送られる。

【0060】

パソコン50は、中央演算処理装置（CPU）を備え、演算処理装置として機能し、受光処理部48から受入する測定データに基づいて、各スパッタ電源（22、26、32、36）を制御する制御装置としても機能する。また、パソコン50によってハロゲンランプ40の発光制御や、基板ホルダー14の回転制御、チャンバー12の圧力制御、導入ガスの供給制御及びシャッター（図1中不図示、図5中符号72、74、76、78）の開閉制御等を行うことができる。パソコン50には各制御に必要なプログラムや各種データが組み込まれている。

【0061】

図1では、膜厚測定用の光学式測定手段の光源部として、ハロゲンランプ40及びモノクロメータ41を用いたが、膜厚モニタリングシステムに使用される光学式測定手段の光源部は、図1の構成例に限定されず、測定対象に応じて適切な光源が選択される。例えば、WDM用フィルターの製造の際には、波長=1460~1580nmのチューナブルレーザー（可変波長レーザー）を用いる。また、単色の測定光を用いる態様に限らず、白色の測定光を用いて受光部側で単色化する態様もある。単色の測定光を利用する態様に比べて、受光部側で単色化をする態様はノイズが少ないという利点がある。

【0062】

次に、上記の如く構成されたスパッタ装置10の動作について説明する。以下に述べる実施例は、低屈折率膜として SiO_2 、高屈折率膜として TiO_2 をそれぞれ反応性スパッタにより成膜する例を説明する。

【0063】

最初に、高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源30の各マグネトロン部31、34、35にはTiターゲット52、53、54が取り付けられており、低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源20の各マグネトロン部21、24、25にはSiターゲット62、63、64が取り付けられている。ターゲットの大きさは、通常用が高さ1.1m、幅15cm、AC用は各々、高さ1.1m、幅10cmのものが用いられる。

【0064】

また、それぞれの基板ホルダー14には、厚さ1.1mm、10cm角のガラス基板18を9枚ずつ、縦方向に並んで取り付ける。次いで、チャンバー12をロータリーポンプで5Paまで粗引きした後、クライオポンプで 1×10^{-3} Paまで排気する。

【0065】

次に、アルゴンガスを100sccm、酸素ガスを30sccm、マスフローコントローラを通してチャンバー12内に導入する。そのときのガス圧は0.4Paであった。

【0066】

SiO_2 膜を成膜するために、 Si ターゲット62が取り付けられている通常のマグネトロン23に直流10kWの矩形波状のパルス電力（周波数50kHz）、 Si ターゲット63、64が取り付けられているACのマグネトロン27に交流20kWの電力をそれぞれ供給し、ターゲットと基板間に配置されているシャッター（図1中不図示）を閉めて五分間の予備放電を行い、その後両方のシャッターを開いて成膜を行う。

【0067】

成膜中は、上記した膜厚モニタリングシステムによって基板ホルダー14上の基板18について透過率を測定する。基板18の透過率は、成膜される膜厚に対応して変化するため、透過率を監視することによって膜厚を把握することができる。参考のために、図3に本実施例における膜厚モニタの信号例を示す。

【0068】

膜厚モニタリングシステムによって膜厚を監視しながら成膜を行い、設計膜厚の90%まで成膜した時点でACのマグネトロン27への電力の供給を止め、通常のマグネトロン23のみで成膜を行う。成膜中は、透過率の測定結果をパソコン50で演算し、その測定結果の情報を各電源26、22にフィードバックすることにより、基板18の回転方向に関する膜の均一性の向上と同時に、膜厚が設計膜厚になるようにコントロールする。なお、基板ホルダー14の回転速度やシャッターの開度（開閉量）を制御して成膜を調整することも可能である。

【0069】

次に、 TiO_2 膜を成膜するために、 Ti ターゲット52が取り付けられている通常のマグネトロン33に直流15kW、 Ti ターゲット53、54が取り付けられているACのマグネトロン37に交流30kWの電力をそれぞれ供給し、 SiO_2 膜の成膜工程と同様に、五分間の予備放電を行った後に、両方のシャッターを開けて成膜を行う。 TiO_2 膜の場合も、設計膜厚の90%まで成膜した時点でACのマグネトロン37への電力の供給を止め、通常のマグネトロン33のみで成膜を行う。成膜中に、透過率の測定結果を各電源36、32にフィードバックして、膜の均一性を向上させ、正確な膜厚管理を行う点は SiO_2 膜の成膜工程と同様である。

【0070】

上述したSiO₂膜の成膜工程及びTiO₂膜の成膜工程を繰り返し行い、ガラス（基板）／SiO₂（94.2nm）／TiO₂（57.3nm）／SiO₂（94.2nm）／TiO₂（57.3nm）／SiO₂（94.2nm）／TiO₂（57.3nm）／SiO₂（188.2nm）／TiO₂（57.3nm）／SiO₂（94.2nm）／TiO₂（57.3nm）／SiO₂（94.2nm）の13層のバンドパスフィルターを作成した。なお、このような膜構成を、ガラス／（SiO₂ 94.2／TiO₂ 57.3nm）³／SiO₂ 188.2nm／（TiO₂ 57.3nm／SiO₂ 94.2nm）³と表記する。

【0071】

この作成されたバンドパスフィルターの分光特性を図4に示す。同図中黒丸（ ）は設計値であり、実線は本実施例による作成したバンドパスフィルターの分光特性の測定結果を示す。点線は、比較のため、前記実施例のACのマグネトロンが無く、電源へのフィードバックシステム無しとした図27のような構成のスパッタ装置を用いて作成したバンドパスフィルターの分光特性の測定結果を示した。図4によれば、本発明を適用して作成したバンドパスフィルターは、ほぼ設計値通りの分光特性を示しているが、電源へのフィードバック無しで作成したものは、バンドパスフィルターの設計波長（550nm）と異なる波長で透過率がピークを持っている。

【0072】

本実施の形態に係るスパッタ装置10を利用することによって、基板18に多層膜を高速で成膜でき、かつ高精度で膜厚制御することが可能になり、WDM用フィルターやダイクロイックミラーなどを生産性よく製造することができる。

【0073】

上記実施例の場合、設計膜厚の90%の膜厚まで、ACのマグネトロンと通常のマグネトロンとを同時稼働させ、その後ACのマグネトロンのみ放電を止めて、通常のマグネトロンのみ放電を継続するようにしたが、制御方式はこの例に限定されない。例えば、90%までACのマグネトロンのみで成膜し、その後通常のマグネトロンのみで成膜するという制御方式も可能である。もちろん、ACの

マグネトロンを止めるタイミングは、設計膜厚の 9 0 % 成膜時点に限定されず、適宜設定可能である。

【 0 0 7 4 】

また、上記実施例では、A C のマグネトロンへの給電中（設計膜厚の 9 0 % に到達するまでの期間）も膜厚をモニタリングしながら膜厚制御を行っているが、A C のマグネトロンへの電力供給中は膜厚のモニタリングはするが膜厚制御は行わず、予め調査されている投入電力とスパッタ時間による膜厚予測値に基づいて時間管理を行い、所定時間経過した時に A C のマグネトロンへの電源を停止してもよい。そして、通常のマグネトロンのみで成膜を開始した時点で膜厚制御（例えば、電源にフィードバックさせて制御する）を開始する態様も可能である。

【 0 0 7 5 】

基板 1 8 上で膜厚を測定する場所（測定ポイント）は、基板 1 8 の中央部の一カ所であってもよいし、回転方向に沿った横方向（「進行方向」という。）について複数箇所の測定を行い横方向の膜厚分布を測定してもよい。更に、基板ホルダー 1 4 の回転軸に沿った縦方向について複数の膜厚測定手段（投光ヘッド 4 4 及び受光ヘッド 4 6）を配置して、縦方向について複数箇所で膜厚の測定を行う態様も可能である。

【 0 0 7 6 】

成膜時には基板ホルダー 1 4 が常に回転した状態にあり、透過率の測定は基板ホルダー 1 4 の 1 回転について 1 サンプル以上（より好ましくは、十二角形の各辺について 1 サンプルずつ合計 1 2 サンプル）行われる。例えば、基板ホルダー 1 4 の回転機構は 1 回転ごとに 1 回の信号を発生する回転位置センサと、基板ホルダー 1 4 の基板取付面が周方向の決められた所定位置を通る際に信号を発生する基板位置センサとを備え、これら位置センサからの信号をトリガとして各サンプルごとに測定を行う。

【 0 0 7 7 】

なお、これら位置センサを省略しても、連続的に測定を行うことで得られる周期的な測定信号を得ることができるため、測定は可能である。ただし、上記のように位置センサを利用することによって、測定信号と測定位置の関係を明確に把

握できるため、正確な測定が可能となる。

【0078】

こうして、基板が回転した状態で得られる透過率のデータ列は膜の透過率の角度依存性を示すデータとなる。このデータ列は理論的には測定光の入射角度 0° の透過率を中心として線対称となるような値をとる。この対称性を利用し、入射角度 0° の透過率を獲得し、更に角度依存性を分光特性に近似変換することができる。近似変換の手法については、図21乃至図26を用いて詳述する。

【0079】

図1に示したスパッタ装置10は、基板ホルダー14の内側に投光ヘッド44を配置し、受光ヘッド46はチャンバー12の外部に設置したが、投光ヘッド44と受光ヘッド46の配置関係を入れ替える態様も可能である。

【0080】

次に、上述した実施形態の変形例を説明する。

【0081】

図5は、他の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置70の模式図である。図5中図1と共通する部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。なお、図5では、図面の簡略化のため、ハロゲンランプ40、モノクロメータ41、光ファイバー42、受光処理部48及びパソコン50等の構成を図示しないものとする（図6及び図7においても同様）。

【0082】

図5に示したスパッタ装置70は、低屈折率膜形成用及び高屈折率膜形成用の双方について、通常のマグネトロン23、33と、ACのマグネトロン27、37の設置場所が隔てられ、各マグネトロン（23、33、27、37）と基板18との間にそれぞれ開閉可能なシャッター72、74、76、78が設けられている。同図では、低屈折率膜を成膜している状態が示され、低屈折率膜形成用の通常のマグネトロン23及びACのマグネトロン27前に配置されたシャッター72、76は開状態、高屈折率膜形成用の通常のマグネトロン33及びACのマグネトロン37前に配置されたシャッター74、78は閉状態となっている。

【0083】

同図において、反応性スパッタプロセスにより所望の膜厚が得られた時点でシャッター72、76を閉じることによって、成膜反応を確実に停止させることができるとともに、成膜に使用しないスパッタ源のシャッター74、78を閉じておくことにより、ターゲットの劣化を防止できる。低屈折率膜の成膜が完了したら、シャッター74、78を開けて高屈折率膜の成膜を実施する。

【0084】

また、図6に示したように、各マグネトロン(23、33、27、37)の左右両脇に防着板80を配置する態様も好ましい。防着板80は、プラズマの回り込みを防止する作用を有し、マグネトロン部正面に位置する基板18に対してのみ成膜作用を制限し、それ以外の基板(隣接する基板)に対する成膜を防止する。防着板80によって各マグネトロンスパッタ源の左右を個別に包囲したことにより、他のマグネトロンスパッタ源によるプラズマの影響を受けず、ターゲットへの不純物の付着を防止できる。

【0085】

図7は、カソード配置のバリエーションを示す図である。本発明の実施に際しては、図7(a)乃至(d)に示すように、カソード配置に関して種々の形態が可能である。同図中「H」なる記号は高屈折率膜形成用のカソード(マグネトロン部)を示し、「L」は低屈折率膜形成用のカソード(マグネトロン部)を示す。図7(a)は、高屈折率膜形成用のカソードと低屈折率膜形成用のカソードを離して配置した例であり、図5で説明した通りである。図7(b)はプラズマの干渉を避けるために、高屈折率膜形成用のカソードと低屈折率膜形成用のカソードを隣接させた例である。同図(c)は膜厚モニタへの干渉を避けるために、モニタ位置をカソードから離れた位置に設定した例である。同図(d)は、膜厚を測定する手段として、透過型のモニタと反射型モニタとを併用した例が示されている。

【0086】

透過型モニタは、図1で説明したように、投光ヘッド44と受光ヘッド46を用いて基板18の透過率を測定する手段である。反射型モニタは、ヘッド82から基板18に向けて光を照射し、その反射光をヘッド82で受光して、受光信号

の解析によって反射率を測定する手段である。図示されていないが、図 1 と同様のハロゲンランプ 4 0、モノクロメータ 4 1 及び光ファイバー 4 2 を用いて反射型モニタのヘッド 8 2 に測定用の光が導かれ、ヘッド 8 2 で受光した光（反射光）は受光信号処理手段を介してパソコン 5 0 に送られる。

【 0 0 8 7 】

図 7（d）のように、透過型モニタと反射型モニタを併用する場合、透過率が低い領域は反射率の測定結果を用いて制御を行い、透過率が高い領域は透過率の測定結果を用いて制御を行う態様が好ましい。すなわち、透過式／反射式の制御の切り替えを判定するための基準となる透過率（判定基準値）を予め設定しておき、この判定基準値よりも透過率が低い場合には、反射率の測定結果を利用して制御を行い、判定基準値よりも透過率が高い場合には、透過率の測定結果を利用して制御を行う。

【 0 0 8 8 】

図 8 には、本発明の実施に際して主に使用されるターゲット材と膜材料が示されている。低屈折率材料としては、既述した Si ターゲットを用いて SiO₂ 膜を形成する態様その他、SiC ターゲットを用いて SiO₂ 膜を形成する態様、ターゲットに Si と Al の合金を用いて SiO₂ と Al₂O₃ とからなる酸化物膜を形成する態様などがある。

【 0 0 8 9 】

高屈折率材料についても、既述した Ti ターゲットを用いて TiO₂ 膜を形成する態様その他、図 8 に示したように、ターゲット材を選択することによって、種々の膜材料を成膜することができる。また、図 8 には示されていないが、ターゲット材は金属（導電性材料）以外にも、DC スパッタが可能な酸化物、窒化物、酸窒化物、炭化物等も使用可能である。

【 0 0 9 0 】

図 9 は、本発明の実施に際して利用される基板の例が示されている。同図に示したように、WDM 用フィルターには、基板として OHARA 社製 WMS（結晶化ガラス）が使用される。また、他の光学フィルター用の基板としては、白板ガラス、硬質ガラス、人工水晶等、図 9 に示した各種のガラスが用途に応じて使用

される。

【0091】

次に、本発明の他の実施形態について説明する。

【0092】

図10は、他の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置100の構成図である。同図中図1及び図5に示した装置と同一または類似の部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。図10において、「低速成膜1」と記載した通常のマグネトロン23及び「高速成膜1」と記載したACのマグネトロン27は、低屈折率膜成膜用のスパッタ源である。また、「低速成膜2」と記載した通常のマグネトロン33及び「高速成膜2」と記載したACのマグネトロン37は、高屈折率膜成膜用のスパッタ源である。

【0093】

これら各マグネトロン23、27、33、37は、その中心線23A、27A、33A、37A（各マグネトロンの中心を通り、ターゲット支持面に垂直な線）が基板ホルダー14の回転中心（中心軸16）と交差するように、回転中心の方向に向いて配置されている。図10のように、基板ホルダー14によって構成される正十二角形の内接円を15A、外接円を15Bとすると、基板ホルダー14と各マグネトロン23、27、33、37までの距離は、基板ホルダー14の回転に伴い、内接円15Aから外接円15Bの範囲で変動する。同図では、基板ホルダー14の基板支持面の中心点と、該基板支持面から見た各マグネトロン23、27、33、37の中心点との距離が最小となったときの状態（基板とターゲットが対向する位置関係の状態）が示されている。

【0094】

シャッター72、72、76、78は、それぞれローラ79の回転力によって開閉動作するように構成され、スパッタ電源22、26、32、36の制御に連動して、対応するシャッター72、72、76、78の開閉が制御される。

【0095】

膜厚モニタリングシステムの光源としてハロゲンランプ40を用いる場合、図10に示すように、モノクロメータ41の出力部にチョッパ84が配置される。

モノクロメータ41からの出力光（単色光）をチョッパ84によって周期的に遮光することにより、パソコン50内のCPU51において光源のノイズ成分を除去する演算が行われる。受光処理部48は、チョッパ84を作動させる変調信号を出力するとともに、入力される受光信号の電圧値をデジタル信号に変換してCPU51に提供するコントロールアンプ（図11中符号49として記載）を備えている。

【0096】

図11は、ハロゲンランプを利用する膜厚モニタリングシステムの詳細な構成を示すブロック図である。ハロゲンランプ40は、ランプ電源86から電力の供給を受けて発光する。ハロゲンランプ40から照射される光（白色光）は、モノクロメータ41によって単色化された後、チョッパ84に入射する。チョッパ84は、コントロールアンプ49から与えられる変調信号に従って作動し、チョッパ84を介して変調された単色光が出力される。この変調された単色光は、光分割手段（ハーフミラーなど）87によって2分割され、その一方は成膜空間となるチャンバー12内に導入されて測定対象の基板18（測定用試料に相当）に照射される。基板18を透過した光はフォトマルメータ85に入射し、透過光の光量に応じた電圧信号に変換される。フォトマルメータ85から出力される電圧信号は、コントロールアンプ49によってデジタル信号に変換された後、CPU51に送られる。

【0097】

また、光分割手段87で分割された他方の分岐光は、光源情報を得るための光としてフォトダイオード88に入射する。コントロールアンプ49は、フォトダイオード88に対してチョッパ84と同期する変調信号を与えており、フォトダイオード88からはモノクロメータ41から出射される光源直接光の光量に応じた電圧信号が出力される。フォトダイオード88から出力された電圧信号は、コントロールアンプ49においてデジタル信号に変換された後、CPU51に送られる。

【0098】

CPU51は、コントロールアンプ49から受入した透過光のデータと光源直

接光のデータに基づいて、透過率の算出、光学膜厚の算出、並びに成膜レートの算出等の演算を行う。

【 0 0 9 9 】

ハロゲンランプ 4 0 の白色光をモノクロメータ 4 1 によって単色化してから基板 1 8 に照射する態様に限らず、白色の測定光を基板 1 8 に照射し、受光側で単色化してもよい。この場合、受光ヘッド 4 6 の前段にモノクロメータが配置される。受光側で単色化する態様は、単色の測定光を用いる態様に比べてノイズが低減される。

【 0 1 0 0 】

図 1 1 に示したシステム構成に代えて、図 1 2 に示すシステム構成も可能である。図 1 2 中図 1 1 と同一または類似の部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。図 1 2 に示した例では、光源部に可変波長レーザー 9 0 が用いられ、コントロールアンプ 4 9 からの変調信号によって出力波長が選択される。また、可変波長レーザー 9 0 は出力が安定しているため、図 1 1 で説明した光源直接光の監視が不要となる。

【 0 1 0 1 】

ところで、カルーセル型スパッタ装置は、正多角形を構成する各基板ホルダーを回転させながら成膜を行う構造であるため、特開平 3 - 2 5 3 5 6 8 号公報でも指摘されているように、正多角形の辺にあたる部分と、稜にあたる部分とでは、ターゲットとの最短接近距離、並びにターゲットに対する基板面の角度の関係が異なる。そのため、基板に対するスパッタ原子の付着確率が異なり、基板の回転方向（回転しながら基板の横幅方向に進む方向という意味で「進行方向」という。）に対する膜厚分布が不均一になるという傾向がある。

【 0 1 0 2 】

図 1 3 にその模式図を示す。図 1 3 (a) は、基板ホルダー 2 0 2 により構成される正多角形の辺にあたる部分がターゲット 2 1 0 に最接近した状態を示し、同図 (b) は、正多角形の稜がターゲット 2 1 0 に最接近した状態を示す。なお、符号 2 2 0 はターゲット 2 1 0 が装着されるマグネトロン部のバックングプレートである。スパッタ原子の付着確率は、ターゲット 2 1 0 から基板 2 0 4 面内

の各位置までの距離 r とその方向（「ベクトル $\langle r \rangle$ 」という。）、及びベクトル $\langle r \rangle$ と基板面とのなす角度 ϕ に依存する。

【0103】

図13（a）及び（b）に示したように、基板ホルダー202の回転に応じて、正多角形の辺にあたる部分と稜にあたる部分とではベクトル $\langle r \rangle$ と角度 ϕ が変化するため、従来の成膜方法では、図13（c）に示すように基板204の周辺部分により多くの原子が付着し、中心部に比べて周辺部の膜厚が大きくなるという傾向がある。

【0104】

本発明においては膜厚分布の均一化を達成するため、本実施形態に係るスパッタ装置100は、図14に示すターゲットが用いられる。図14（a）は断面図、同図（b）は平面図である。このターゲット92は、図10の符号23及び符号33で示した低速成膜用のスパッタ源に適用されるものであり、図14に示した通り、ターゲット上表面面が中央位置（ドラム17の回転軸方向に沿う稜線92C）をピークとして左右両方向に傾斜した、いわゆる屋根形（逆V字形）の形状を有している。水平面に対する傾斜角度 θ は、基板ホルダー14で構成される正多角形の角数、直径、基板の大きさ、基板－ターゲット間の距離（設計上の平均距離）などに依存して、膜厚分布の均一化を実現し得るように最適な角度に設計される。

【0105】

従来のターゲットは、板厚が一定の平板形であり、基板とターゲットが対向した位置関係になった時に、基板面とターゲット面が平行状態となっていた（図13（a）参照）。これに対し、図14に示したターゲット92は、基板とターゲットが対向した位置関係になった時に、ターゲット面が基板面に対してわずかに角度を持っている（傾斜角度 θ ）状態となる。

【0106】

上記の如く構成されたターゲット92を用いると、図15（a）、（b）に示したように、スパッタ原子はターゲット傾斜面92A、92Bから放出されるため、その飛散分布（スパッタ原子の密度）はターゲット傾斜面92A、92Bの

法線方向に広がる（つまり、V字形の放出となる）。また、原子放出面となるターゲット傾斜面92A、92Bと基板18の各位置までの距離とその方向（ベクトル $\langle r \rangle$ ）、並びにベクトル $\langle r \rangle$ と基板面との成す角度 ϕ の関係等の諸条件がバランスよく均整化されることにより、図15（c）に示したように、基板18の進行方向（図において横方向）についての膜厚の均一化を実現できる。

【0107】

図16は、本発明による傾斜形のターゲット92を用いた成膜による膜厚分布と、従来の平板形のターゲット（通常ターゲット）を用いた成膜による膜厚分布とを比較したグラフである。同図に示したグラフは、下記の実施条件の下で得られた実験結果である。すなわち、図10に示したスパッタ装置100において、直径1mの正十二角形を構成する各基板ホルダーを用い、基板－ターゲット間距離60mm、基板サイズ10cm角とし、符号23（または33）で示した低速成膜用のスパッタ源に「通常ターゲット」を装着して成膜を行った結果と、傾斜形のターゲット92（傾斜角度 $\theta = 5^\circ$ ）を装着して成膜を行った結果である。

【0108】

図16から明らかなように、通常ターゲットでは基板の中心に比べて周辺部分の膜厚が大きくなるが、本発明による傾斜形のターゲット92の場合には、膜厚の進行方向分布が均一化される。

【0109】

上記した低速成膜用のスパッタ源と同様に、図10中符号27、37で示した高速成膜用のスパッタ源については、図17に示す傾斜形のターゲット94、95が適用される。図17（a）の断面図及び同図（b）の平面図に示したターゲット94は、図10の符号63、54に示したターゲットとして用いられる。また、図17（c）及び（d）に示したターゲット95は、図10の符号64、53に示したターゲットとして用いられる。高速成膜用のスパッタ源（ACのマグネトロン）において、隣接して配置される二つのターゲットのターゲット面を同方向に傾斜させても膜厚の均一化を達成することはできないため、これら二つのターゲットは互いに線対称（または略線対称）の関係で配置される。

【0110】

図17に示した各ターゲット94、95の傾斜角度 θ は、スパッタ装置の具体的条件に依存して最適な角度に設計される。図1でも説明した通り、高速成膜用に用いられるACのマグネトロンは、二つの隣接するマグネトロン部に装着されたターゲットのアノード／カソード関係が交互に切り替えられ、全体として一つのスパッタ源として作用し得るものであるため、図17に示したように、左右のターゲット94、95がそれぞれ単一の傾斜面（片側のみが傾斜する、いわゆる楔形）を有することで、これら二つのターゲット94、95を組み合わせ使用する場合に、図14で説明したターゲット92と同等の屋根形のターゲット面が構成される。図17に示したターゲット94、95の作用については、図15と同様である。

【0111】

図18は、図17に示した傾斜形ターゲット94、95を用いたACのマグネトロンによる膜厚分布と、従来の平板形ターゲット（通常ターゲット）を用いたACのマグネトロンによる膜厚分布とを比較したグラフである。図18に示したグラフは、下記の実施条件の下で得られた実験結果である。すなわち、図10に示したスパッタ装置100において、直径1mの正十二角形を構成する各基板ホルダーを用い、基板－ターゲット間距離60mm、基板サイズ10cm角とし、符号27（または37）で示した高速成膜用のスパッタ源に「通常ターゲット」を装着して成膜を行った結果と、傾斜形ターゲット94、95（両者とも傾斜角度 $\theta = 5^\circ$ ）を装着して成膜を行った結果である。

【0112】

図18から明らかなように、通常ターゲットでは基板の中心に比べて周辺部分の膜厚が大きくなるが、本発明による傾斜形ターゲットの場合には、膜厚の進行方向分布が均一化される。

【0113】

図17に示したターゲット94、95に代えて、図19に示すターゲット96、97を用いる態様も可能である。すなわち、図19（a）、（b）に示したターゲット96は図17のターゲット94と置換され、図19（c）、（d）に示したターゲット97は、図17のターゲット95と置換される。図19に示した

ように、ACのマグネトロンに適用する左右のターゲット96、97の上表面をそれぞれ屋根形（「Λ」形）に構成する態様も可能である。この場合、内側の傾斜面96A、97Aの傾斜角（ $\theta 1$ ）と、外側の傾斜面96B、97Bの傾斜角（ $\theta 2$ ）は、スパッタ装置100の構成条件等に依存して適切な値に設計される。これにより、膜厚の進行方向分布が均一化される。

【0114】

次に、膜厚のモニタリング方法に関する他の実施形態を説明する。

【0115】

目標とする光学膜厚 nd （ただし、 n は膜の屈折率、 d は物理膜厚）に対して、次式（1）

【0116】

$$\text{【数1】 } nd = m\lambda / 4 \quad \dots (1)$$

ただし、 m は正の整数、 λ は光の波長とする。

【0117】

を満たすような波長 λ の光を測定光として用い、この測定光を成膜中の基板に垂直入射させて（入射角度 $=0^\circ$ ）、その透過率（または反射率）を測定すると、成膜された膜の光学膜厚が測定波長 λ の $1/4$ の整数倍となるとき（すなわち、上記式（1）を満たすとき）に、透過率（または反射率）が極値をとる。

【0118】

図20は、ガラス基板上に TiO_2 （ $n=2.4$ ）の膜を形成した時の測定波長 $550nm$ に対する透過率の変化を示したグラフである。同図において、横軸は成膜された膜厚（物理膜厚 d ）を示し、縦軸が透過率を示す。同図に示したように、光学膜厚 nd が $\lambda/4$ の整数倍のときに透過率が極値を示している。

【0119】

かかる現象を利用して、目標とする膜厚に対して上記式（1）を満たす測定波長 λ の光を用いて、膜厚のモニタリング及び成膜制御を行うことができる。

【0120】

しかし、図1や図10で示したようなカルーセル型スパッタ装置の場合、基板ホルダー14が回転しているために、測定光の入射角度と測定位置（モニタ位置

）は常に変化している。測定光の入射角度が変化したとき、透過率の値が大きく変化してしまうと、精度のよい測定及び成膜制御が困難になる。実際、10層以上の膜構成の場合、測定光の入射角度が変化することで透過率の極値の位置や透過率が変化してしまうため、従来の方法では膜厚測定及び成膜制御を行うことが困難である。

【0121】

上記のような問題を解決するための手法について、以下、具体的な例を用いて説明する。

【0122】

図21は、ガラス／(TiO₂ 92.9nm／SiO₂ 57.3nm)⁷／TiO₂ 185.8nm／(SiO₂ 57.3nm／TiO₂ 92.9nm)⁷の膜構成からなる29層1キャビティのバンドパスフィルター（中心波長550nm）を成膜したときの波長550nmの測定光による透過率の変化を示すグラフである。

【0123】

成膜過程での各段階における膜の光学的な性質に着目して、図21に示したように区間A～Dの4区間に分けすることができる。

【0124】

区間A（第1層～第12層）は、透過率が膜厚に大きく依存し、測定光の入射角度には殆ど依存しない区間である。実際、0°入射の透過率と10°入射の透過率の値はほぼ一致している。区間B（第13層～第18層）は、透過率が膜厚にも入射角度にも殆ど依存せず、また、透過率の変化が少ない区間である。区間C（第19層～第29層）は、透過率が膜厚にも入射角度にも依存する区間である。0°入射の透過率と、10°入射の透過率とでは大きく異なり、10°入射の透過率は小さい値（10%未満）となっている。また、区間D（第29層）は、光学特性を調整するための区間である。

【0125】

各区間ごとに、それぞれ適したモニタリング及び成膜制御を行い、モニタリングの精度と、膜の光学的性質の制御性を向上することができる。以下に、各区間での制御方法を示す。

【0126】

＜区間Aでの膜厚制御＞

図22は、1層目、2層目、3層目、及び9層目の成膜中に得た透過率のデータの角度依存性を示すグラフである。第1層から第12層までの区間（区間A）では、図22に示すように、入射角度が変化しても透過率は殆ど変化しない。したがって、基板が回転する中で連続的に取得される透過率のデータを入射角度 $\pm 5^{\circ}$ ～ $\pm 15^{\circ}$ 程度の範囲内の平均値をとることで、垂直入射時の透過率とほぼ同等の値を得ることができる。得られた垂直入射時の透過率から、透過率が極値となる時間を算出し、実際に透過率の値が極値となる値になった時点で成膜を停止する方法により膜厚を制御することができる。なお、測定対象となる基板18は回転しているために、 0° 入射時には基板18の中心を測定しているが、入射角度が大きくなるほど、基板の中心からずれた位置をモニタすることになる。しかしながら、図14乃至図19で説明した傾斜形のターゲットを利用したことで、基板の進行方向に対する膜厚分布は均一化されていることと相まって、モニタ位置が変動しても膜厚を正しく測定することができる。

【0127】

＜区間Bでの成膜方法＞

第13層から第18層までの区間では、透過率の値が小さく、膜厚の増加に対する透過率の変化が小さいため精度のよい膜厚制御が困難である。したがって、この区間Bでは、透過率は参考データとしてのみデータを収集し、主として、第1層から第12層までの成膜工程における透過率の変化量と成膜時間の関係から、現状の成膜レートを算出して、所望の膜厚が得られる時間になったときに成膜を停止する方法により、膜厚を成膜時間で制御する。

【0128】

＜区間Cでの成膜方法＞

図23は、28層目以降の透過率の角度依存性を示すグラフである。第19層から第29層までの区間（区間C）では、図23に示すように、透過率の値が角度に依存して変化するため、区間Aのような制御方法が困難となる。しかし、図23に示すように、入射角度 0° のときの透過率を示す点は、測定によって取得

される透過率曲線が線対象の対象軸と交わる点となるため、入射角度 0° のタイミングを示す厳密なトリガがなくても、測定によって得られた透過率のデータを演算処理することにより、垂直入射時（入射角度 0° ）の透過率を求めることができる。また、測定により得られる透過率曲線のピーク位置や、角度に対する変化率または面積（つまり曲線の形状）から極値をとる膜厚を判定することができる。更に、角度を変化させて得られた透過率曲線を近似変換することにより、図24に示すように、測定波長 λ の長波長側の分光透過率を得ることができる。

【0129】

図24は、入射角度 $0^\circ \pm 10^\circ$ の範囲で取得される透過率曲線のデータを近似変換して得られる分光透過率のグラフである。 $\pm 10^\circ$ の範囲のデータを利用することにより、測定波長 λ （ $= 550\text{ nm}$ ）の長波長側、すなわち、 $550\text{ nm} \leq \lambda \leq 552.35\text{ nm}$ の分光透過率を予測できる。この予測値は、図24に示した通り、実際の分光透過率（実験によって確認される分光透過率）と極めて高い精度で一致している。

【0130】

<区間Dでの成膜方法>

1層目から順次成膜してきた過程の中で、実際の膜厚が目標膜厚に対して誤差を生じたために、所望の光学特性が得られていないことがある。このような場合、成膜過程の中で光学特性の修正を行う層が設けられる。本例では、この修正用の層を第29層（最終層）とし、これを区間Dとした。

【0131】

この区間Dでは、式（1）を満たすような測定波長（ $\lambda = 550\text{ nm}$ ）から僅かに短波長側にずらした波長の測定光を利用して透過率の測定を行う。本例では波長 $\lambda = 549\text{ nm}$ の測定光によって測定を行い、図25に示すような信号を得た。こうして得られた測定データを用いて、前述の区間Cと同様に、近似変換を行うことにより、図26に示すように、測定波長 $\lambda = 549\text{ nm}$ の長波長側、すなわち $549\text{ nm} \leq \lambda \leq 551.35\text{ nm}$ の分光透過率を求めることができる。

【0132】

このようにして求めた分光透過率は、実際の分光透過率と極めて高い精度で一

致している。成膜工程中に、図26に示したような分光透過率のプロファイルを得ることにより、バンドパスフィルターの光学仕様となる「中心波長」、「特定波長での透過率」、及び「バンド幅」を全て観測することができる。これにより、目標とする仕様を満たすように確認しながら膜厚（すなわち、光学特性）を補正することが可能となり、製品の歩留り（良品率）を向上させることができる。

【0133】

上述の例では、測定波長 $\lambda = 550\text{ nm}$ から僅かに短波長側にずらした測定光として $\lambda = 549\text{ nm}$ の光を用いたが、測定に使用する光の波長は、測定しようとする膜の種類、段数（階層数）に応じて切り替えられる。

【0134】

上記実施の形態では、透過率を算出する例を述べたが、本発明の実施に際しては、透過率に代えて、またはこれと併せて、反射率を算出してもよい。

【0135】

図10に示したスパッタ装置100は、装置内の全てのマグネトロン部に傾斜形ターゲットを装着したが、本発明の実施に際しては、一つの装置内に通常ターゲットと傾斜形ターゲットとが混在する態様も可能である。

【0136】

〔膜厚のモニタリング精度を向上させる技術〕

次に、膜厚の測定精度を高める方法について説明する。

【0137】

成膜中に透過率または反射率の光学特性を測定する場合、投光部以外からの光（主としてマグネトロン部周辺の成膜空間で発生するプラズマ光）を受光部が検出してしまい、精度の高い分光測定が困難であるという課題がある。この課題に対し、チョッピング周波数に同期するロックインアップを用いてノイズを少なくすることが可能である。

【0138】

しかしながら、スパッタリング成膜におけるプラズマ発光強度は時間的に不安定であることから、そのノイズを完全に除去することは難しい。特に、測定光の強度が比較的弱くなる条件での測定においては、プラズマの迷光に起因するノイ

ズが問題となる。

【0139】

かかる課題を解決するために、本発明の実施形態では、成膜空間に対して測定部（受光部及び投光部）を基板ホルダーの回転の周方向にずらして配置し、プラズマ光の影響を小さくしている。図30に示した例では、マグネトロン（23、27、33、37）が配置されている位置から周方向に最も離れた位置に測定部が配置されている。なお、図30において、図1と共通する部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。図30に示したように、成膜空間からモニタリングの位置を離すことで、S/N比を向上し、精度の良いモニタリングを行うことができる。

【0140】

成膜空間とモニタリングの位置との離間量（距離）は、実際の装置構成によって様々な設計可能であるが、受光部に最も近いマグネトロンの中心線とチャンバー外壁との交点を基準点として、外壁面上の周長に沿って水平方向に150mm以上、より好ましくは900mm以上離れた位置とすることが好ましい。

【0141】

更に、受光ヘッド46と投光ヘッド44の間、つまりチャンバー壁面に形成された測定用の窓と基板ホルダー14の間にチャンバー12と基板ホルダー14の間隔と略等しい長さの遮光筒120を配設して、測定光の光路を覆うことが好ましい。そして、この遮光筒120をチャンバー12と電氣的に絶縁してフローティング状態にすることにより、成膜空間からのプラズマ迷光を大幅に遮断できる。

【0142】

図31は、図30の31-31線に沿う断面図である。図31同図に示したように、受光ヘッド46は、ステージ122を介してチャンバー12の外壁に取り付けられている。遮光筒120は測定光の光路を覆うようにチャンバー12の内壁に取り付けられている。なお、符号124は光ファイバー42を支持する支持管である。

【0143】

図32は遮光筒120の平面図、図33はその側面図である。遮光筒120の本体はSUS304などの金属材料で形成されており、該遮光筒120は絶縁板126を介してチャンバー12に取り付けられる。取り付けには絶縁ブッシュ128が用いられ、図示せぬボルトにより固定される。なお、絶縁板126や絶縁ブッシュ128の材料としては、例えば、フッ素樹脂であるテフロン（ポリテトラフルオロエチレンの商標名）が好ましい。勿論、遮光筒120の本体をテフロンその他の絶縁材料で形成する態様も可能である。

【0144】

遮光筒120の先端部には遮光蓋130が設けられている。遮光蓋130は黒色に着色されたテフロンによって形成されており、遮光蓋130の中央には投射光のスポット直径と略同じ大きさの穴131が形成されている。なお、遮光筒120本体がフローティング状態になっている場合、遮光蓋130の材料として、SUS304のような導体を使用することも可能であるが、本例では、基板18と遮光蓋130との間の多重反射による迷光の影響を抑制するために、多重反射防止の観点から黒テフロンを使用している。

【0145】

上記手法により、プラズマ光に起因するノイズを大幅に低減でき、チョッピング周波数が270Hz程度の比較的低い場合でも精度の良い測定が可能となる。実験によれば、フローティングポテンシャルの遮光筒120を設けることにより、S/N比は200倍向上した。図30乃至図33で説明した手法は、図1乃至図26で説明した各実施形態に適用される。

【0146】

〔ACマグネトロンのみを使用する実施形態〕

上述した実施の形態では、AC方式のマグネトロンのみと通常タイプのマグネトロンの併設されたカルーセル型スパッタ装置で成膜を行い、なおかつ連続的に膜の光学特性（透過率または反射率）の測定を行うことで目標膜厚と成膜中の膜厚との差が大きい場合には高速側マグネトロン（ACマグネトロン）と低速側マグネトロン（通常のマグネトロン）を同時に放電して成膜を行い、目標膜厚との差が小さくなったら低速側マグネトロンのみで成膜を行うことで精密な膜厚制御を行

い、所望の光学特性を持つ積層膜を得ることができる例を述べた。このような態様は、通信用バンドパスフィルタのような膜厚誤差0.01%以下という高精度の膜厚精度を必要とする膜構成に必要となる装置構成である。

【0147】

これに対し、図34に示したように、ディスプレイ、プロジェクター、照明器具、各種カメラレンズ用の部品等の用途に使用される低反射膜、エッジフィルタ（赤外線反射フィルタ、紫外線反射フィルタ、赤外紫外線反射フィルタ、可視光反射フィルタ等）、偏光フィルタなどの膜厚誤差が1~5%程度しか要求されない膜構成の場合には、低速成膜用マグネトロンなしの装置構成で要求を満たすことができる。

【0148】

膜厚誤差が1%程度のオーダーしか要求されない仕様の積層膜を成膜する手段として、低速成膜用マグネトロンを使用せずに高速成膜用マグネトロンのみで成膜を行う方法及び装置の形態について以下に説明する。

【0149】

図35にAC方式のマグネトロンのみを用いた成膜装置の概略図を示す。同図中図1の例と同一または類似する部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。この成膜装置140は、高さ1.5m、直径1.5mの円筒状チャンバー12内に直径1mの正十二角形を構成する各基板ホルダー14が中心軸16を回転中心として回転可能に支持されており、チャンバー壁の内側には長さ1mの矩形型ターゲット二つ一組としたACのマグネトロン27、37が配置された構成を有し、基板18を載せた基板ホルダー14を30rpmの速度で回転させ、ACのマグネトロン27、37の前を基板18が通過することによって成膜を行うカーセル型スパッタ装置である。本例の成膜装置140は、低折率膜形成用と、高屈折率膜形成用にそれぞれACのマグネトロン27、37が設置されている。

【0150】

本成膜装置140は、ハロゲンランプ40からの光をモノクロメータ41、チョッパ84及び光ファイバー42を通して投光ヘッド44に導き、回転中の基板18に対して投光ヘッド44から測定用の光を照射する。基板18を透過した光

は、基板ホルダー14と測定用窓の間の遮光筒120を通して受光ヘッド46の積分球とフォトダイオードで受光される。こうして、成膜を行いながら基板18と成膜された膜の透過率を測定する。

【0151】

その測定結果をパソコン50で演算して、所望の膜厚になるようにマグネトロン制御盤142にフィードバックしている。なお、マグネトロン制御盤142は、ACのマグネトロン27、37に供給する電源等を制御する制御部である。既述の通り、ACマグネトロンは、マグネトロンカソードを二つ並べて配列し、片方のマグネトロンがカソードのときは、もう一方のマグネトロンがアノードとなり、数十kHzの高周波数でカソードとアノードが入れ替わるマグネトロンであり、反応性スパッタリングの遷移領域に成膜条件を保つように成膜パラメータ制御を行うことで、安定かつ高速に酸化物或いは窒化物等を成膜することができる。

【0152】

勿論、ターゲットの形態として、図14や図17で説明した傾斜形のターゲットを用いることも可能である。

【0153】

以下、図35に示した成膜装置を使用した成膜の手順を説明する。

【0154】

まず、高屈折率膜形成用のACマグネトロン37にTaターゲット151、152を取り付けるとともに、低屈折率膜形成用のACマグネトロン27にSiターゲット161、162を取り付け、厚さ1.1mm、10cm角のガラス基板18を基板ホルダー14に取り付ける。そして、図示せぬロータリーポンプを用いて真空チャンバー12を5Paまで粗引きした後、ターボ分子ポンプで 2×10^{-4} Paまで排気する。

【0155】

排気後、高屈折率膜形成側のガス導入口より、アルゴンガス370sccm及び酸素ガス180sccmを導入し、放電を開始した。高屈折率膜形成用のACのマグネトロン37について、遷移領域またはその付近に成膜の状態を保つように電力またはガス流量などを制御し、基板ホルダー14の1回転につき約0.4nmの成膜

速度で成膜を行う。この際、成膜を行いながら、1回転ごとに変化する透過率の測定を行う。

【0156】

チャンバー12に形成された測定用の窓と基板ホルダー14の間には遮光筒120が配置される。図32及び図33で説明したように、遮光筒120は、投光ヘッド44から照射される光のビーム径とほぼ同じ大きさの穴131を有し、基板ホルダー14と前記窓との距離とほぼ同じ長さに形成されている。遮光筒120は電氣的にフローティングポテンシャルとなっており、受光部付近まで広がるプラズマの影響を抑制することができる。この手法により、チョッピングの周波数が比較的低い場合でも精度のよい測定が可能となり、精度が良く、測定速度の速い膜厚モニタリングが可能となる。

【0157】

こうして得られた透過率のデータから、所望の膜厚に対する現在の成膜膜厚を演算し、その結果をマグネトロン制御盤142にフィードバックを行う。目標膜厚に到達したらACのマグネトロン37への電力供給をストップするか、或いは、目標膜厚に近づいた段階でシャッタを低速で閉める（シャッターが閉まるまでに基板ホルダーが数回～数十回回転する程度の速度で閉める）ことにより、回転方向の均一性と同時に膜厚が設計値となるようにコントロールする。

【0158】

また、上記のフィードバック制御において、目標膜厚と現在の膜厚の差を考慮して、成膜パラメータを変化させる事で段階的に成膜速度を制御し、膜厚の精度を向上させ、成膜時間を短縮させることも可能である。

【0159】

次に、低屈折率膜である SiO_2 の成膜を行うために、アルゴンガス250 sccm、及び酸素ガス140 sccmを導入し、放電を開始した。ACのマグネトロン27については、遷移領域またはその付近に成膜の状態を保つように電圧を制御し、基板ホルダー14の1回転につき約0.4 nmの成膜速度で成膜を行った。この際、高屈折率膜形成時と同様の手法を用いて、1回転ごとに透過率を測定し、所望の膜厚が得られるようにACのマグネトロン27を制御する。

【0160】

こうして高屈折率膜の形成と、低屈折率膜の形成を交互に繰り返し、可視光反射フィルターを作成した。

【0161】

また、上記と同様の同様の手法によって直径4インチのシリコンウェーハの基板上に、基板/ Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) / Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) / Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) / Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) / Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) / Ta_2O_5 (200nm) / SiO_2 (200nm) の10層の積層膜を成膜した。

【0162】

この成膜前後にシリコンウェーハの表面をTencor Instruments社のFLX THIN FILMS STRESS MEASUREMENT SYSTEMであるFlexus F2320を使用して曲率半径を測定し、その測定値の差から積層膜の応力は圧縮応力で117MPaであると求められた。

【0163】

図36に、膜特性の評価結果を示す。なお、同図表においては、比較のために、DC方式のマグネトロンのみを使用して成膜した26層3.0 μm の積層膜の評価結果と、蒸着品である34層4 μm の積層膜の評価結果も併記する。各項目の測定方法は、下記の通りである。

【0164】

・膜応力は、Tencor Instruments社のFLX THIN FILMS STRESS MEASUREMENT SYSTEMであるFlexus F2320を使用して、成膜前及び成膜後の直径10cm(4インチ)のシリコン基板の反り(曲率半径)を測定することにより求めた。

【0165】

・屈折率及び消衰係数は、J.A.Woollam Co.,Inc.の分光エリプソメーターWVAS E32 を使用して求めた。

【0166】

・ヘーズ値は、有限会社東京電色のヘーズメーターTC-HIIIを使用して求めた。

【0167】

・平滑性は、セイコーインスツルメンツ株式会社の多機能ユニットSPA-400 を使用して求めた。

【0168】

・波長シフトの求め方は、次の通りである。①日本分光株式会社の自動光学素子測定装置ART-25GTを使用してサンプルの分光透過率を測定する。②サンプルをタバイエスベック株式会社の小型環境試験機SH-220に入れ、60℃、90%RHの設定で120時間保持する。③サンプルを小型環境試験機SH-220から取り出し、自動光学素子測定装置ART-25GTを使用して分光透過率を測定する。④上記した①と③の測定結果のずれを波長シフトとする。

【0169】

図37には参考として、光学多層膜に要求される膜特性の目標値の一覧を示す。

【0170】

図35乃至図36に示したように、ACマグネトロンのみを使用して成膜を行うと、膜応力、屈折率、消衰係数、ヘーズ値、平滑性、耐久性（波長シフト）の点で優れた結果が得られる。また、約4μm以下の膜厚において、DCスパッタ及び蒸着法では膜厚が増えるにつれて表面粗さ（Ra）が大きくなるが、ACスパッタ法では膜厚によらず表面粗さは約0.5nm程度の小さい値を示すという結果が得られた。

【0171】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、カルーセル型スパッタ装置において、成膜中に膜厚をモニタリングし、その情報を利用して成膜量に影響するパラメータを制御するようにしたので、膜厚を正確にコントロールすることができ、所望の膜厚の膜を生産性よく形成することができる。

【0172】

本発明の他の態様によれば、AC型マグネトロンスパッタ源と、単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネトロンスパッタ源とを併用し、設

計膜厚（目標膜厚）手前の一定量までは、ＡＣ型マグネトロンスパッタ源を使用した高速成膜を実施し、一定量の成膜を得た後に、ＡＣ型マグネトロンスパッタ源による成膜を中止し、単一のマグネatron部にターゲットが取り付けられたマグネatronスパッタ源のみを使用するようにしたので、膜厚を高精度で制御でき、生産性よく成膜することができる。

【0173】

更に、膜厚の測定手法として、測定光の入射角度と透過率または反射率の関係を示すプロファイルを利用することにより、成膜の終点などを確実に決定することができる。

【0174】

本発明の更に他の態様によれば、透過率または反射率の入射角度依存性から近似変換を行い、分光透過率または分光反射率のプロファイルをリアルタイムで把握することができ、これを膜厚コントロールにフィードバックすることにより、最終製品のプロファイルを所望のもの（所望の光学仕様のもの）に仕上げる事ができる。これにより、製品の良品率を飛躍的に向上させることができる。

【0175】

また、本発明の更に他の態様によれば、カルーセル型スパッタ装置において、従来の平板形のターゲットに代えて、またはこれと併用して、傾斜形のターゲットを用いたことにより、基板の進行方向についての膜厚の均一化を容易に実現できる。特開平3-253568号に開示されているように、二つのカソードと、該カソードに電力を印加するための二つの電源を用いたスパッタリング方法（装置）で膜厚の均一化を図る場合は、二つのカソードでの成膜速度を等しくする必要があるが、實際上、成膜速度に影響する要因の差をカソード間で小さくすることは困難である。本発明の方法及び装置によれば、膜厚の均一化を図るカソードー電源システムは一つの電源のみを有する構成が可能となるために、前述した要因への影響は小さく、より簡単に膜厚の均一化を図れるとともに、従来と比較して装置の構成もコンパクトで安価にできるという利点がある。

【0176】

要求される膜厚精度によっては、ＤＣ型のマグネatronを使用せずに、ＡＣ型

マグネトロンのみを使用して成膜を行うことも可能である。AC型マグネトロンのみを使用して成膜を行うことにより、優れた特性を有する多層膜が得られる。

【0177】

また、本発明において膜厚測定の精度を高める手段として、測定部の位置を成膜空間から離すことにより、測定におけるプラズマ光の影響を低減できる。更に、測定光が通過する光路の周囲を遮光筒によって包囲し、該遮光筒をチャンバーと絶縁して電氣的にフローティングにすることで成膜空間からのプラズマ迷光を大幅に遮断できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置の構成を示す平面模式図

【図2】

図1に示した装置で使用される基板ホルダーの斜視図

【図3】

本実施例における膜厚モニタの信号例を示すグラフ

【図4】

本実施例により作成したバンドパスフィルターの分光特性を示すグラフ

【図5】

本発明の他の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置の模式図

【図6】

図5に示したスパッタ装置に防着板を付加した例を示す模式図

【図7】

種々のカソード配置の例を示す図

【図8】

本発明で主に使用されるターゲット材と膜材料を例示した図表

【図9】

本発明で使用される基板の例を示した図表

【図10】

本発明の他の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置の構成図

【図 1 1】

ハロゲンランプを利用する膜厚モニタリングシステムの詳細な構成を示すブロック図

【図 1 2】

可変波長レーザーを利用する膜厚モニタリングシステムの詳細な構成を示すブロック図

【図 1 3】

従来のカルーセル型スパッタ装置における膜厚分布の不均一性を説明した模式図

【図 1 4】

(a) は本発明の実施形態に係るターゲットの断面図、(b) はその平面図

【図 1 5】

傾斜形のターゲットの作用を説明した模式図

【図 1 6】

図 1 4 に示した傾斜形のターゲットを用いた成膜による膜厚分布と、従来の平板形のターゲット（通常ターゲット）を用いた成膜による膜厚分布とを比較したグラフ

【図 1 7】

高速成膜用のスパッタ源に適用される傾斜形のターゲットの構成図

【図 1 8】

図 1 7 に示した傾斜形のターゲットを用いた成膜による膜厚分布と、従来の平板形のターゲット（通常ターゲット）を用いた成膜による膜厚分布とを比較したグラフ

【図 1 9】

高速成膜用のスパッタ源に適用される傾斜形のターゲットの他の構成例を示す図

【図 2 0】

ガラス基板上に TiO_2 を成膜した時の波長 550 nm の光透過率の変化を示す

グラフ

【図 2 1】

ガラス / (TiO₂ 92.9nm / SiO₂ 57.3nm)⁷ / TiO₂ 185.8nm / (SiO₂ 57.3nm / TiO₂ 92.9nm)⁷ の膜構成からなる 29 層 1 キャビティのバンドパスフィルター（中心波長 550 nm）を成膜したときの波長 550 nm の測定光による透過率の変化を示すグラフ

【図 2 2】

図 2 1 中の区間 A における成膜中に得た透過率のデータの角度依存性を示すグラフ

【図 2 3】

図 2 1 中の第 28 層目以降の成膜中に測定される透過率の角度依存性を示すグラフ

【図 2 4】

測定波長 550 nm を用いて入射角度 0° ± 10° の範囲で取得される透過率曲線のデータを近似変換して得られる分光透過率のグラフ

【図 2 5】

測定波長 549 nm を用いて入射角度 0° ± 10° の範囲で取得される透過率曲線のデータを示すグラフ

【図 2 6】

図 2 5 に示したデータを近似変換して得られる分光透過率のグラフ

【図 2 7】

従来の光学多層膜成膜用のスパッタ装置の構成を示す概略図

【図 2 8】

基板ホルダーの平面図

【図 2 9】

基板ホルダーの他の形態を示す平面図

【図 3 0】

本発明の実施形態に係る光学多層膜成膜用のスパッタ装置の構成を示す平面模式図

【図 3 1】

図 3 0 の 3 1 - 3 1 線に沿う断面図

【図 3 2】

遮光筒の平面図

【図 3 3】

遮光筒の側面図

【図 3 4】

膜構成の概要と成膜方式を示す図表

【図 3 5】

A C 方式のマグネトロンのみを用いた成膜装置の概略図

【図 3 6】

膜特性の評価結果を示す図表

【図 3 7】

光学多層膜に要求される膜特性の目標値の一覧を示す図表

【符号の説明】

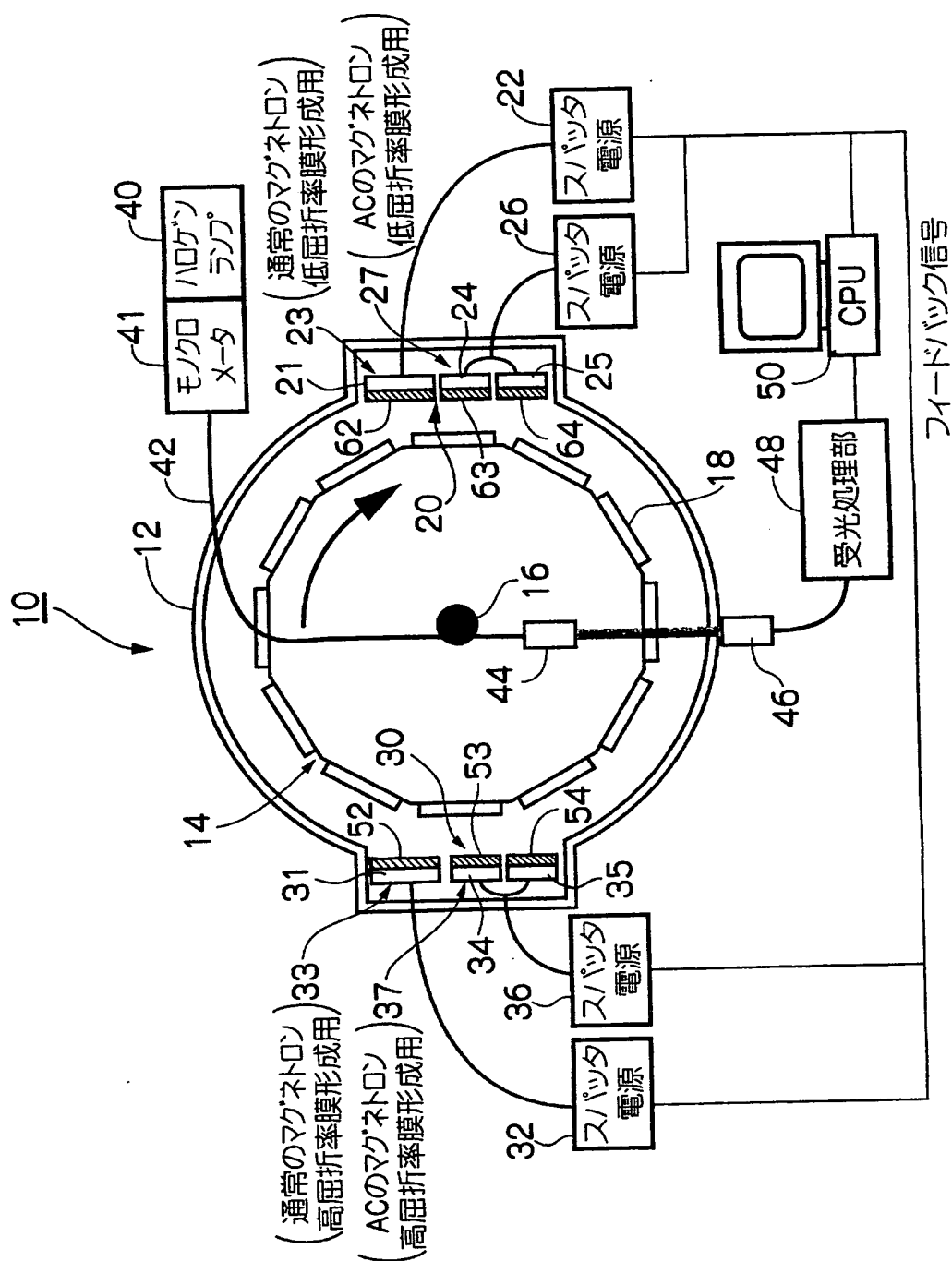
10…スパッタ装置、12…チャンバー、14…基板ホルダー、14A…測定用穴、16…中心軸（回転軸）、17…ドラム、18…基板、18A、18B…モニタ対象基板、20…マグネトロンスパッタ源（低屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源）、21…マグネトロン部、22…電源、23…通常のマグネトロン、23A…中心線、24、25…マグネトロン部、26…交流電源、27…ACのマグネトロン、27A…中心線、30…マグネトロンスパッタ源（高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源）、31…マグネトロン部、32…電源、33…通常のマグネトロン、33A…中心線、34、35…マグネトロン部、36…交流電源、37…ACのマグネトロン、37A…中心線、40…ハロゲンランプ、41…モノクロメータ、42…光ファイバー、44…投光ヘッド（膜厚測定手段）、46…受光ヘッド（膜厚測定手段）、48…受光処理部、49…コントロールアンプ、50…パソコン（制御手段、演算手段）、51…CPU（制御手段、演算手段）、52、53、54…Tiターゲット、62、63、64…Siターゲット、70…スパッタ装置、72、74、76、78…シャッター、8

0…防着板、82…反射型モニタのヘッド、84…チョッパ、85…フォトマル
 メータ、86…ランプ電源、87…光分割手段、88…フォトダイオード、90
 …可変波長レーザー、92…ターゲット、92A, 92B…ターゲット傾斜面、
 92C…稜線、94, 95, 96, 97…ターゲット、96A, 96B, 97A
 , 97B…傾斜面、100…スパッタ装置、120…遮光筒、122…ステージ
 、124…支持管、126…絶縁板、128…絶縁ブッシュ、130…遮光蓋、
 131…穴、140…成膜装置、142…マグネトロン制御盤、151, 152
 …Taターゲット、161, 162…Siターゲット、200…チャンバー、2
 02…基板ホルダー、204…基板、206…低屈折率膜形成用のマグネトロン
 スパッタ源、208…高屈折率膜形成用のマグネトロンスパッタ源、210, 2
 12…ターゲット、214…中心軸、216, 218…スパッタ電源

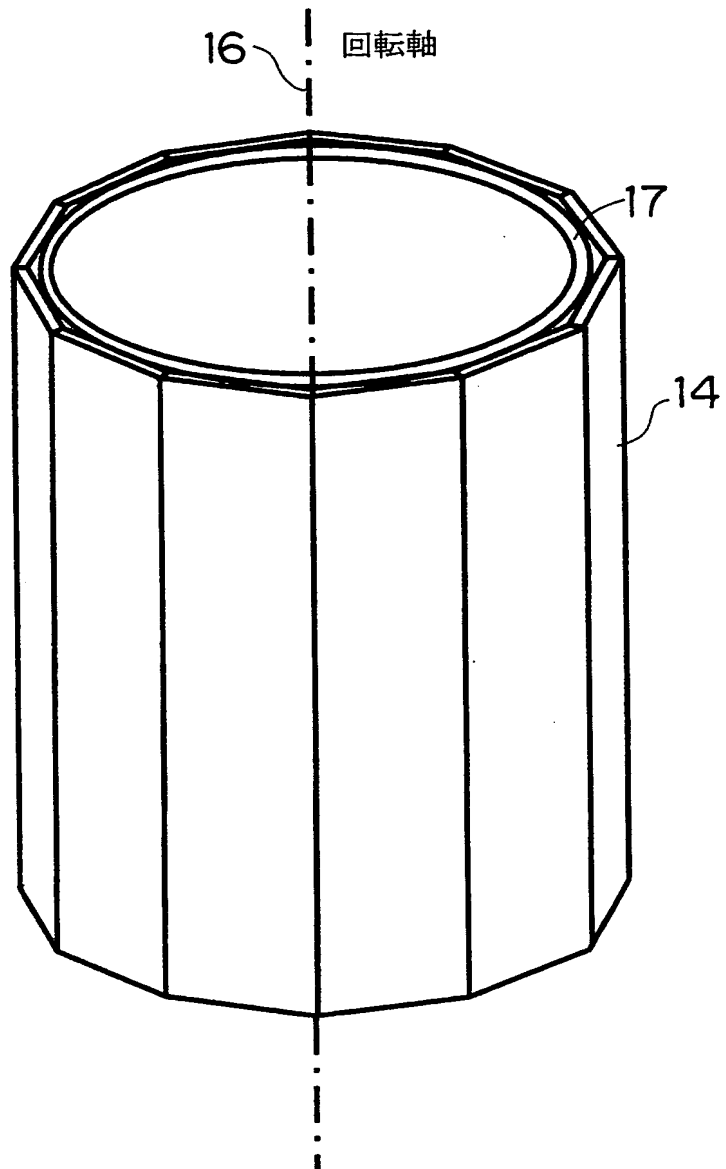
【書類名】

図面

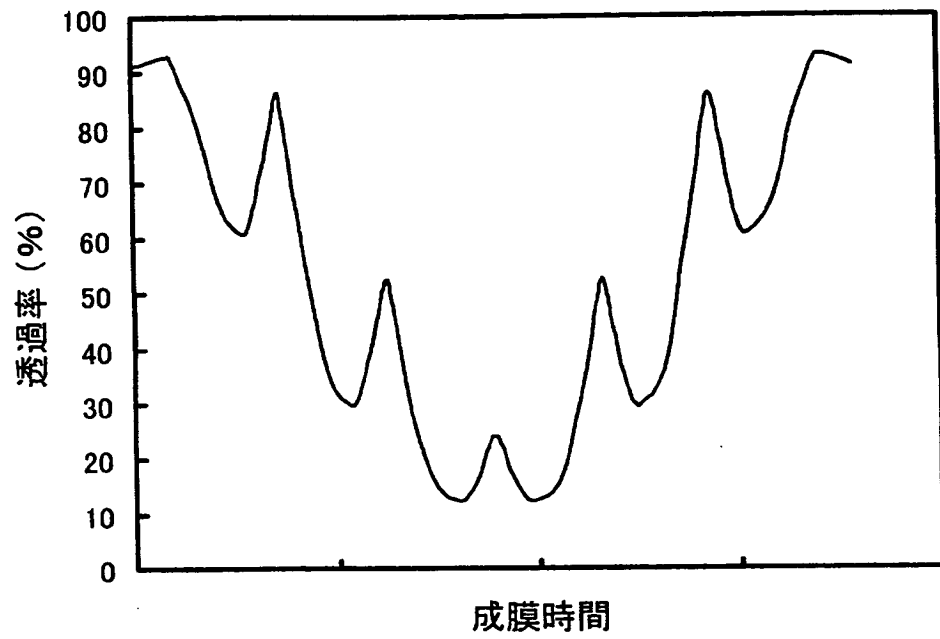
【図 1】



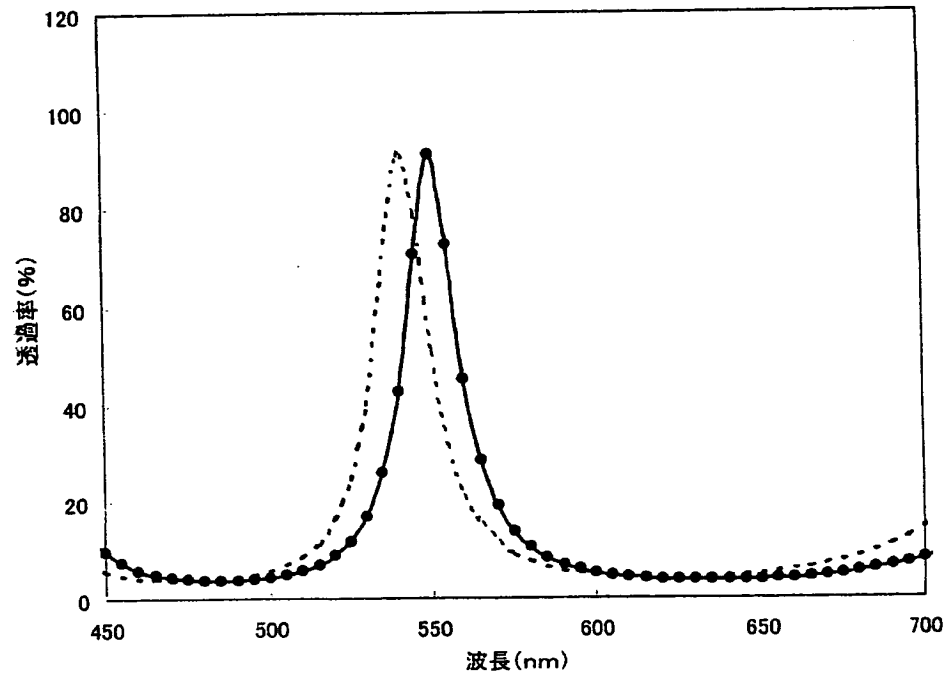
【図 2】



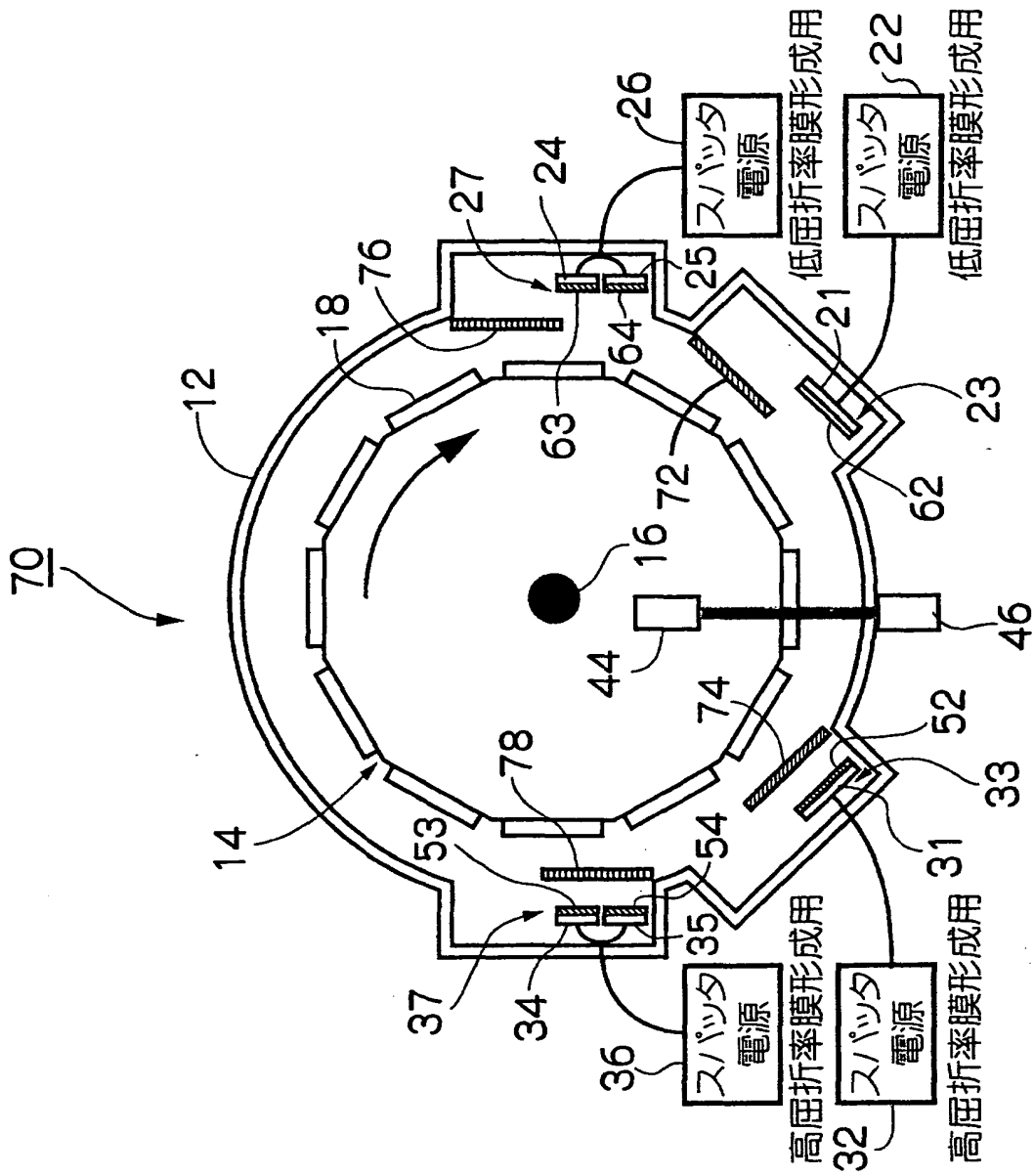
【図3】



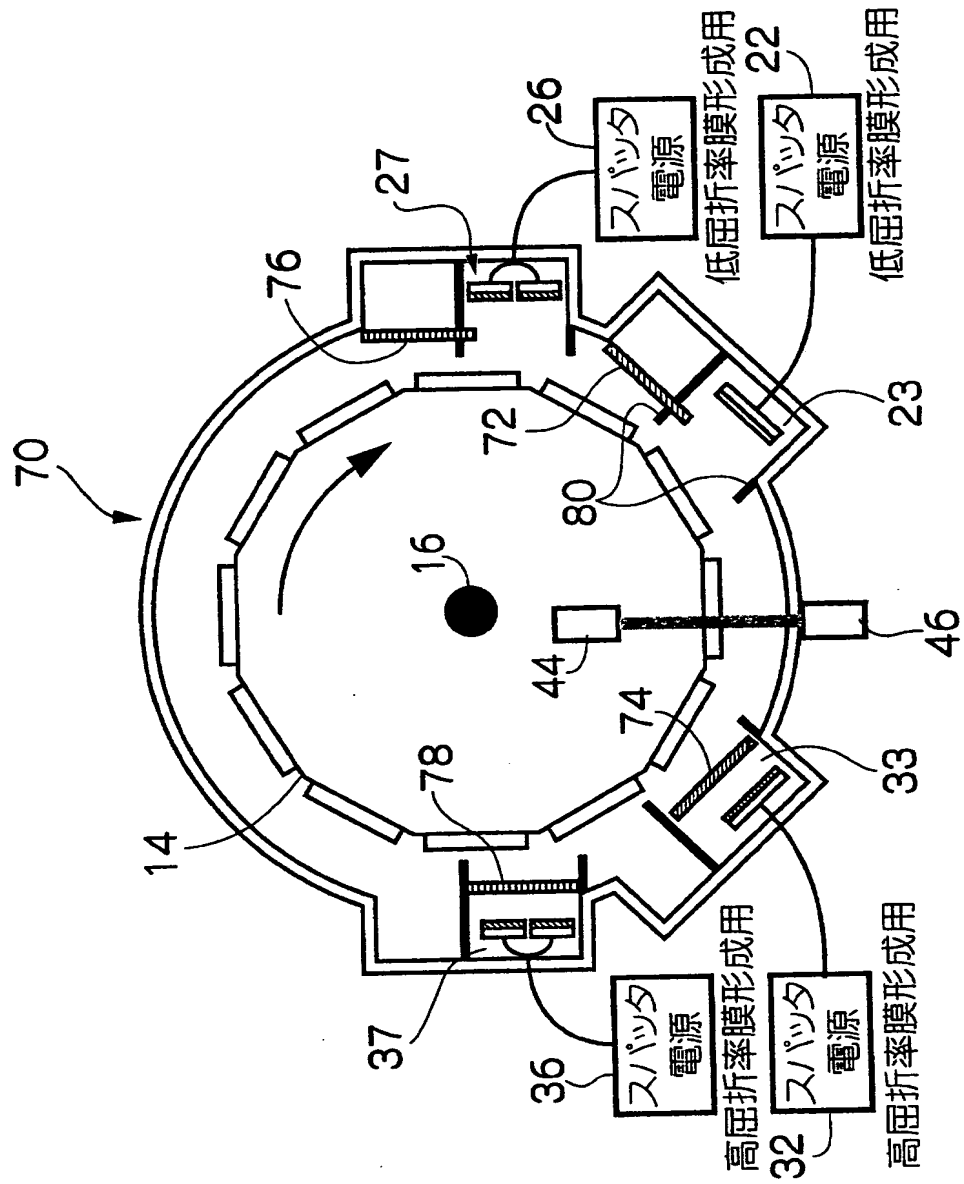
【図4】



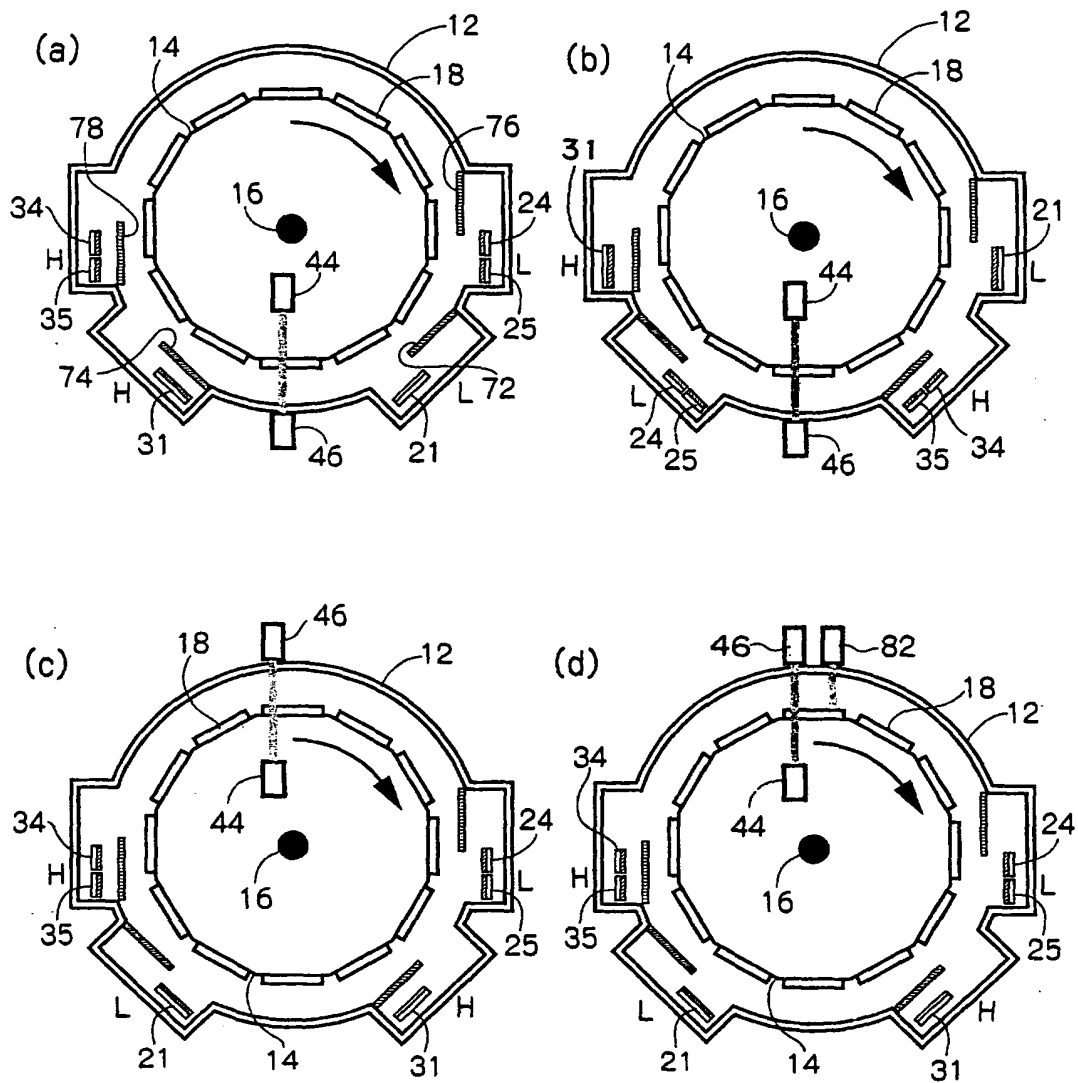
【図5】



【図 6】



【図7】



【図 8】

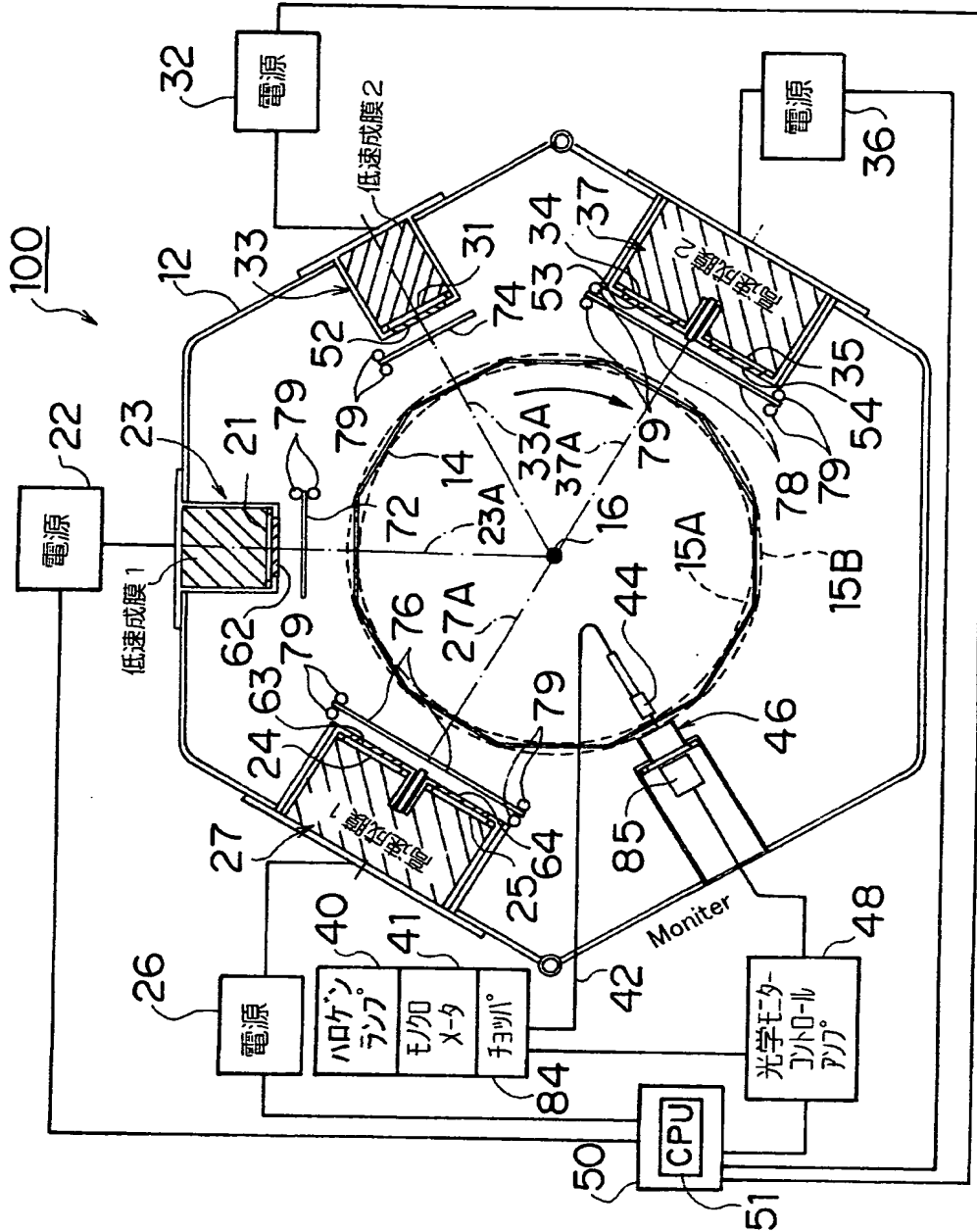
| 低屈折率材料 | ターゲット材 | 膜材料 |
|--------|----------|--|
| | Si | SiO ₂ |
| | SiC | SiO ₂ |
| | SiとAlの合金 | SiO ₂ +Al ₂ O ₃ |
| 高屈折率材料 | Ti | TiO ₂ |
| | Ta | Ta ₂ O ₅ |
| | Zr | ZrO ₂ |
| | Zn | ZnO |
| | Nb | Nb ₂ O ₅ |

【図 9】

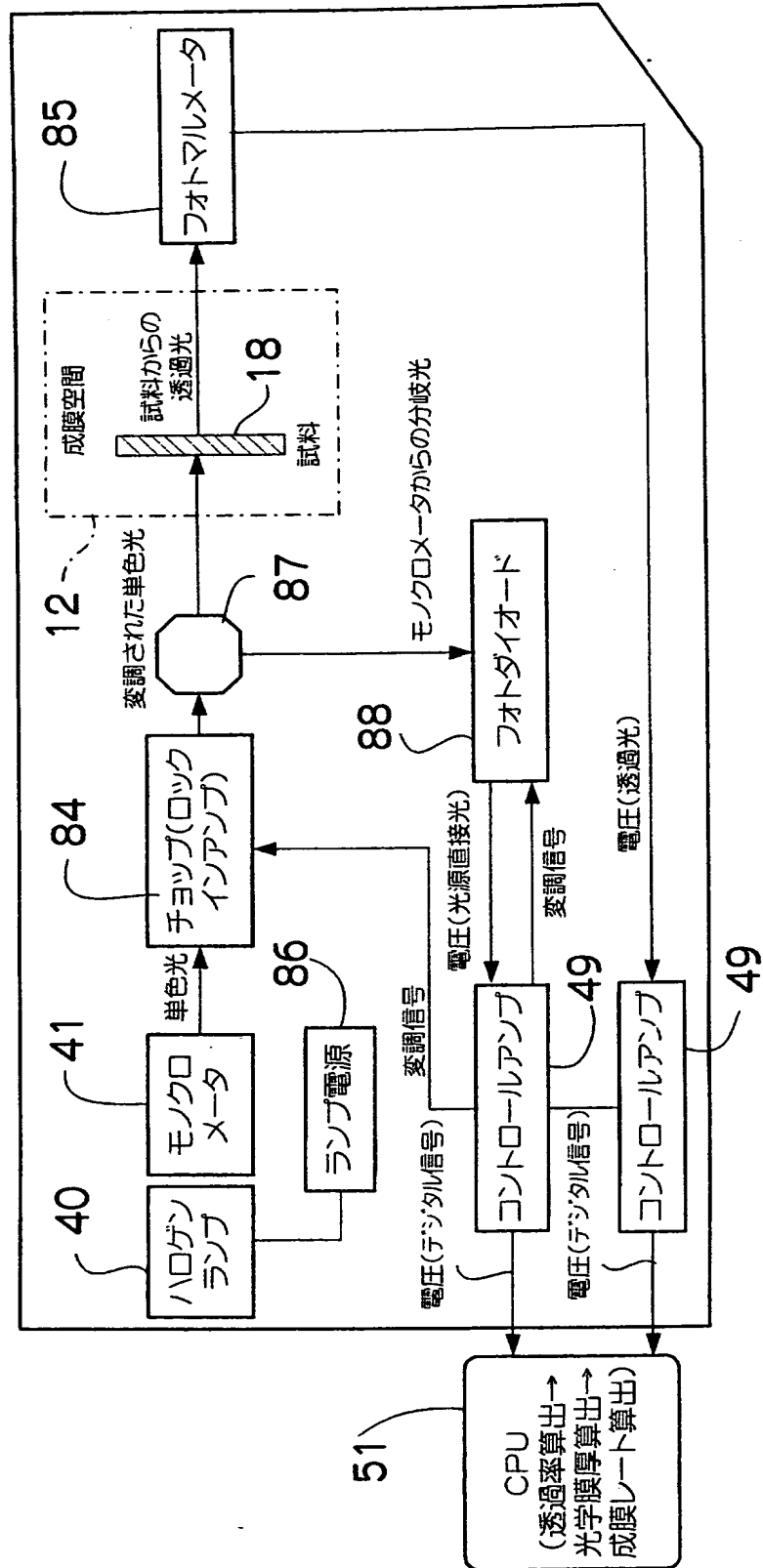
本発明で使用する基板例

| WDM用 | OHARA社製 WMS(結晶化ガラス) |
|----------|------------------------|
| 光学フィルター用 | 白板ガラス (高透過ガラス) |
| | 硬質ガラス (低膨張ガラス) |
| | 人工水晶 |
| | 石英 |
| | ショット社製 BK-7(光学ガラス) |
| | 弗燐酸系ガラス |
| | 硼珪酸系ガラス |

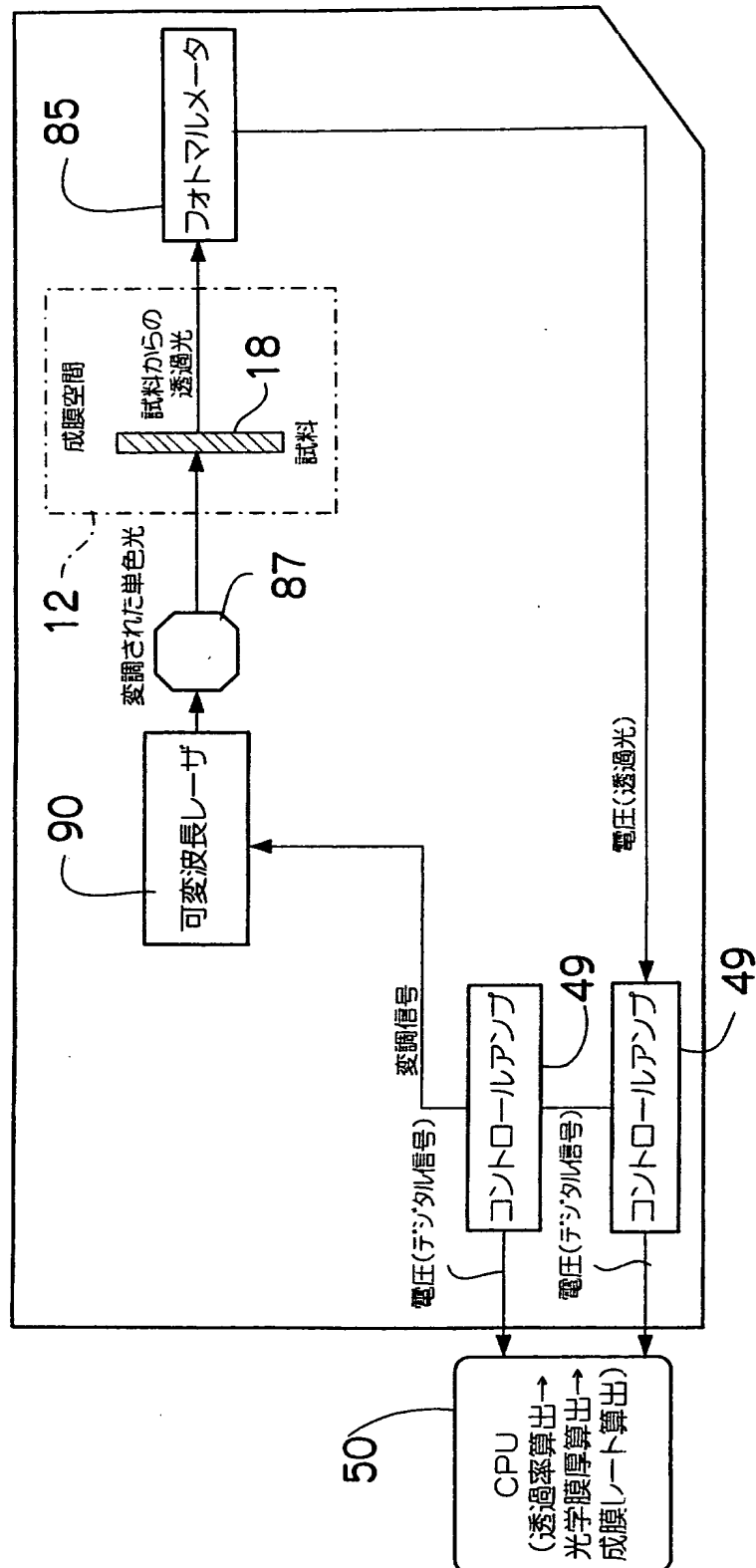
【図10】



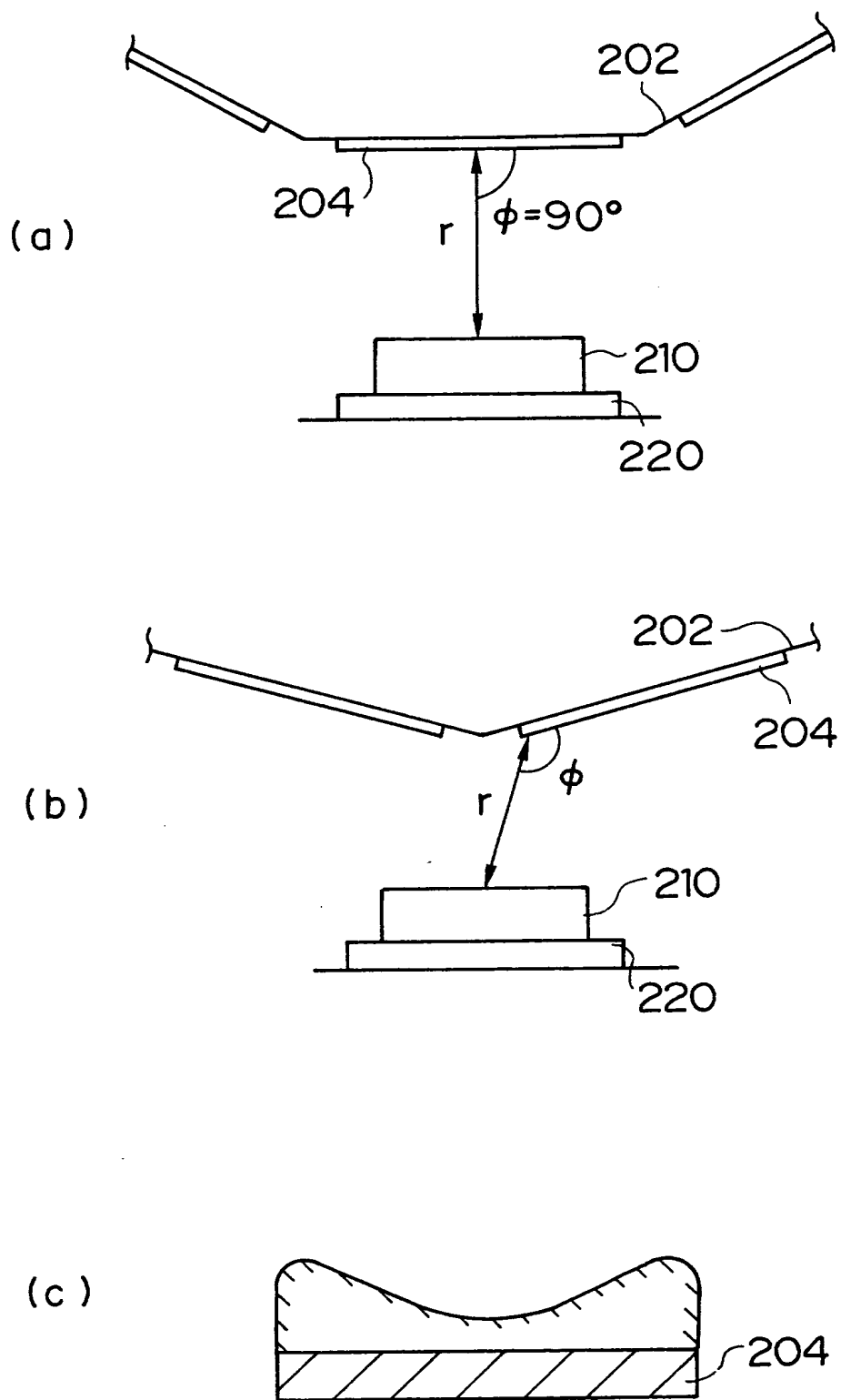
【図 1 1】



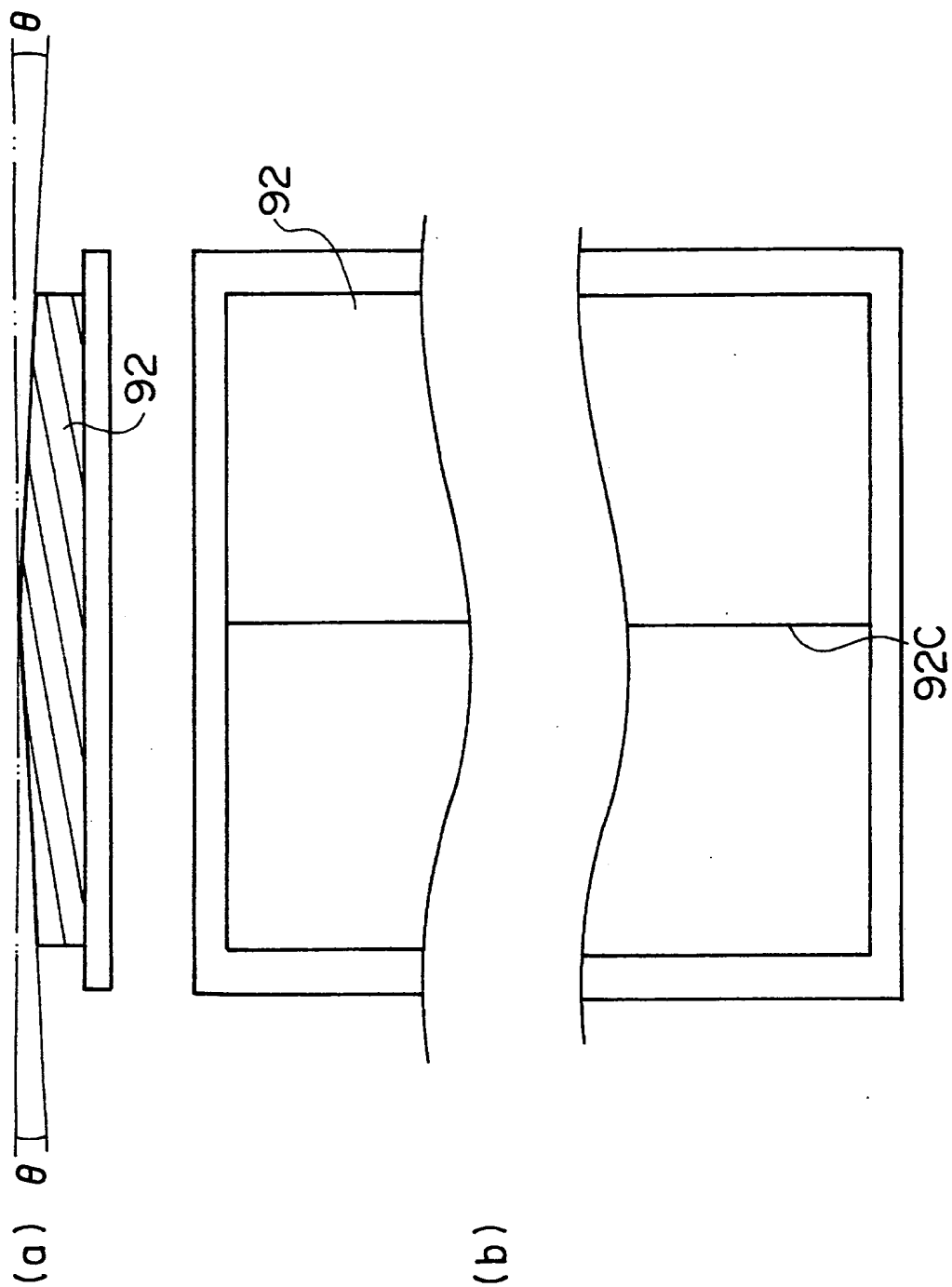
【図 12】



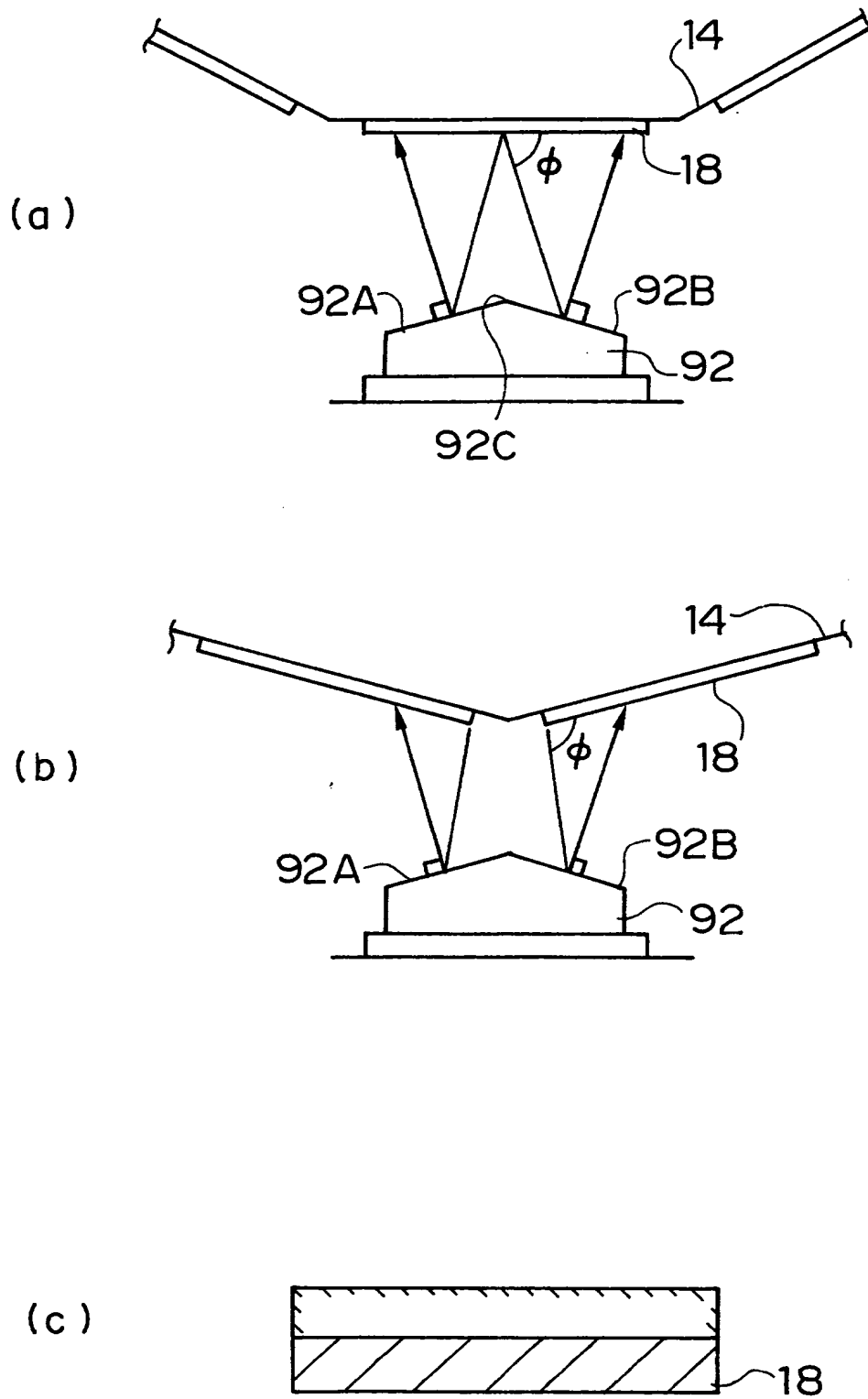
【図13】



【図 1 4】

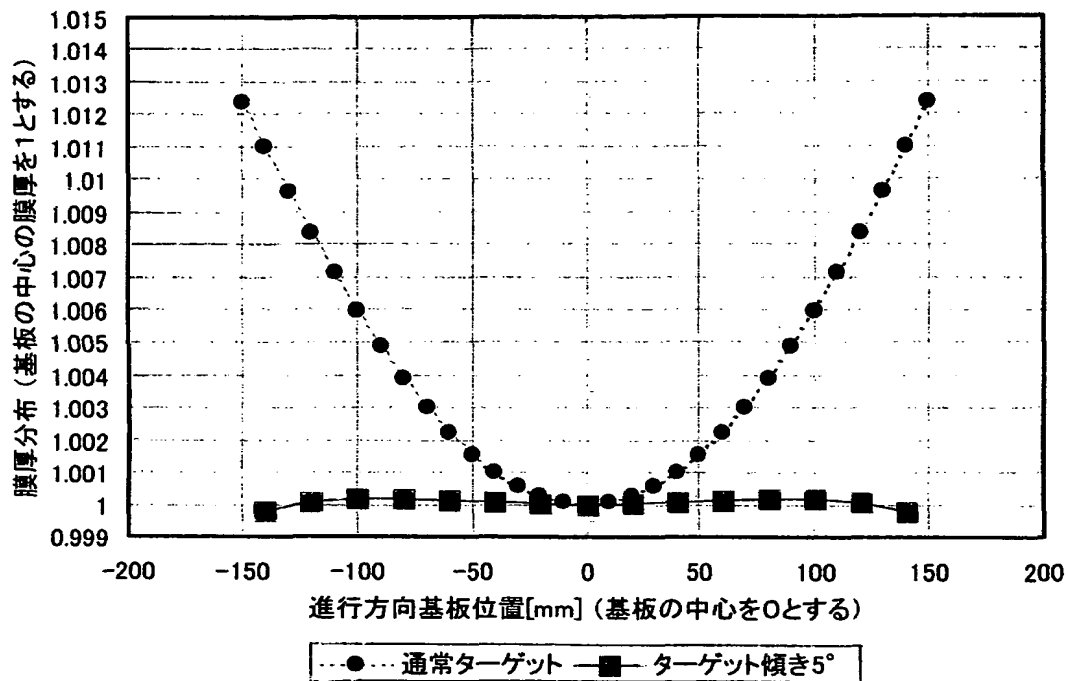


【図 1 5】

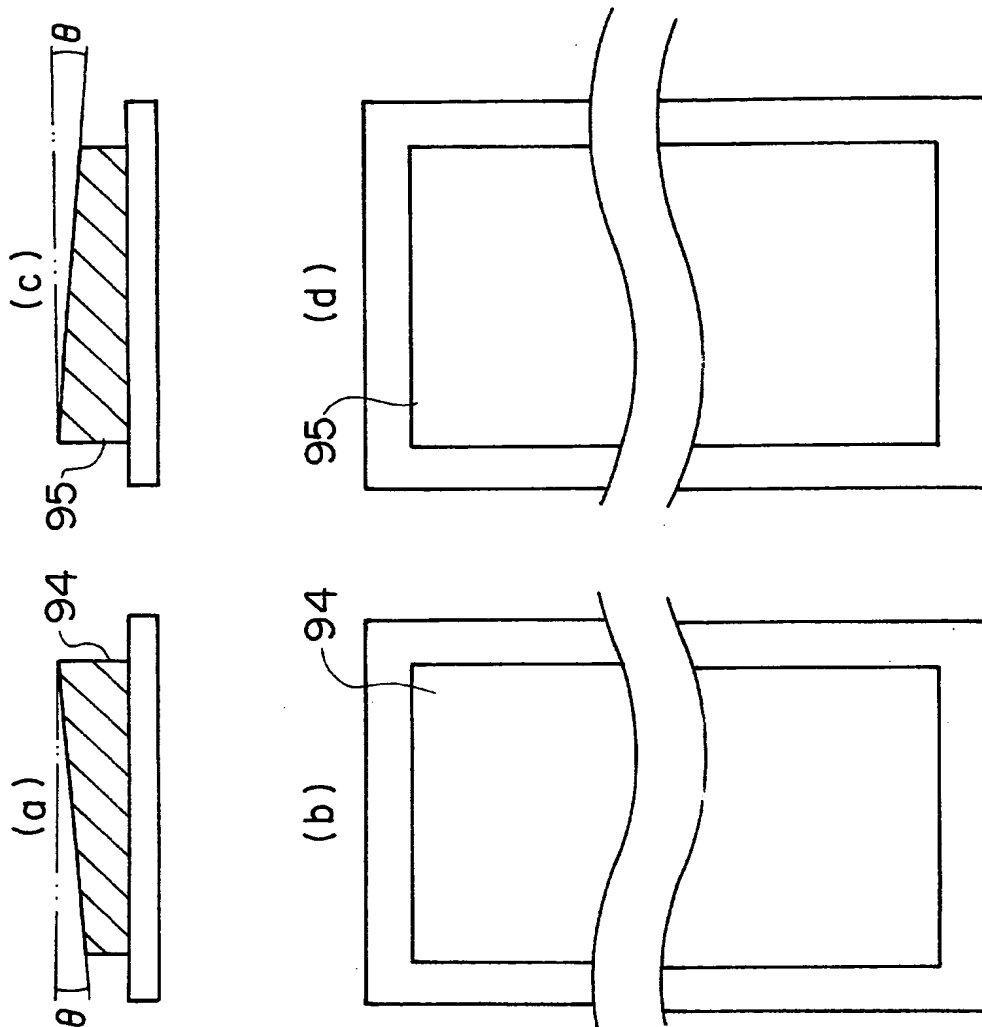


【図 16】

低速成膜ターゲット カルセル型成膜 進行方向分布

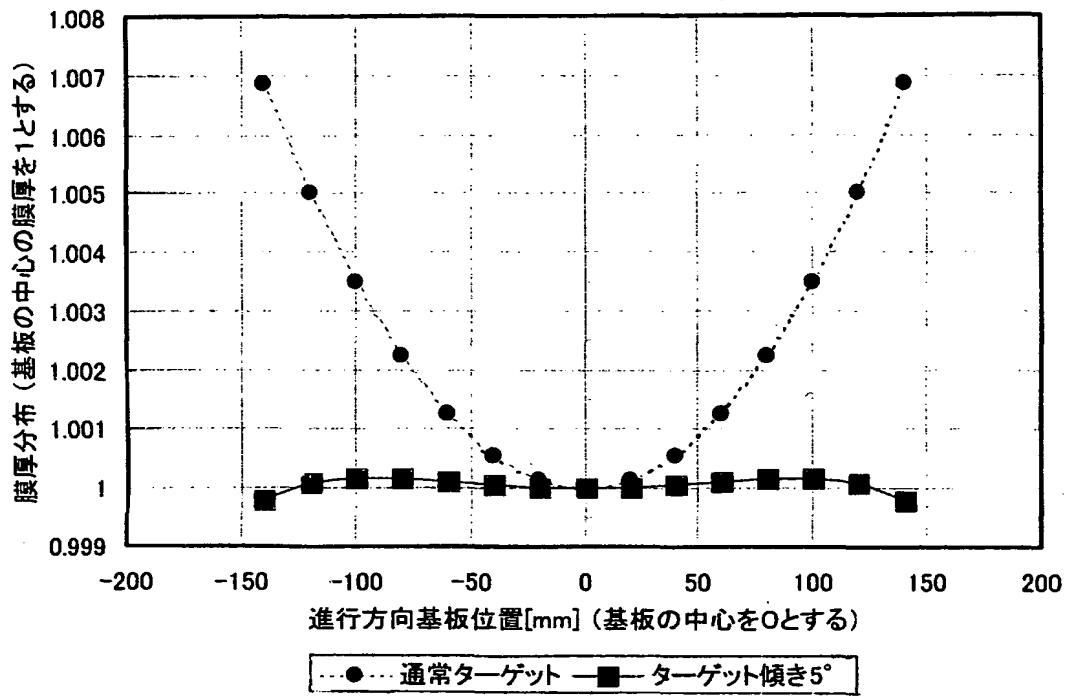


【図 1 7】

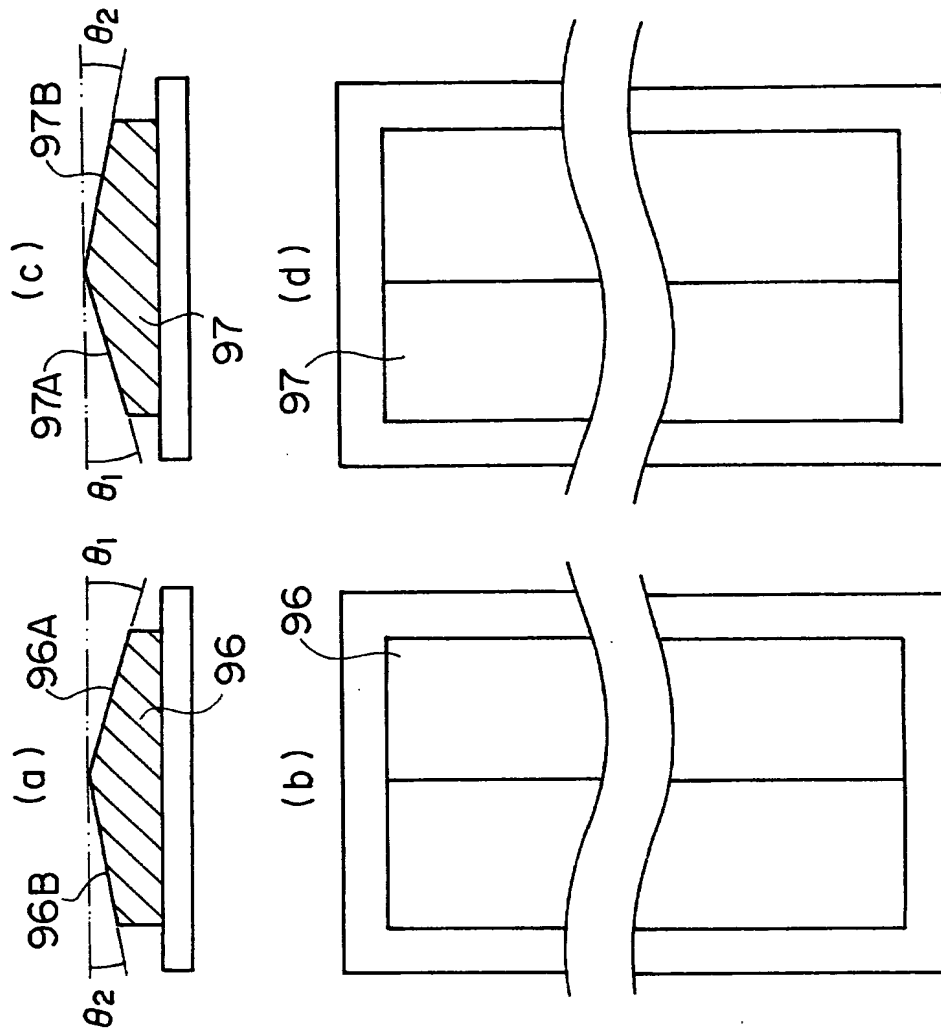


【図18】

高速成膜側ターゲット カルーセル型成膜 進行方向分布

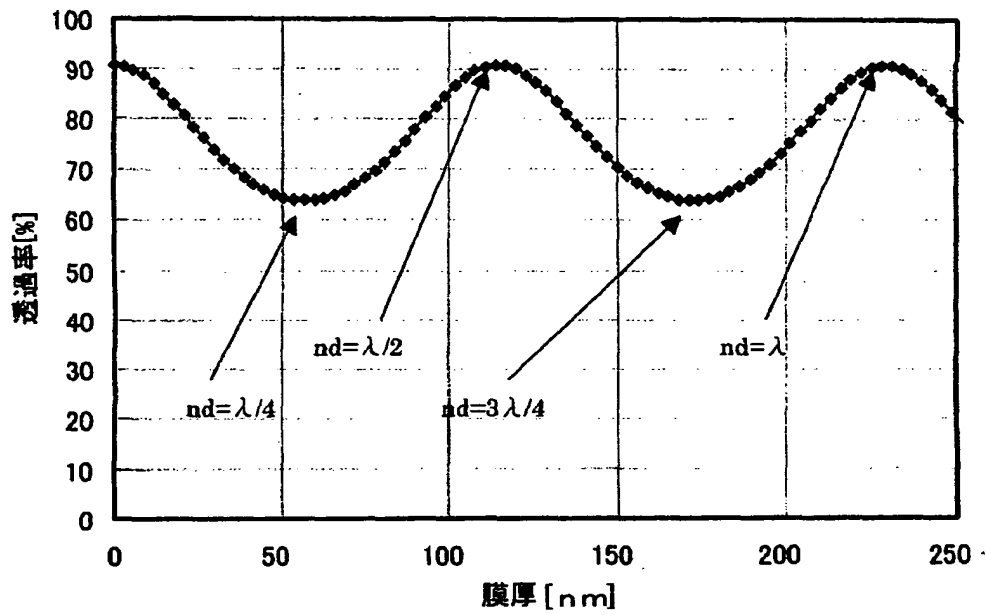


【図 1 9】

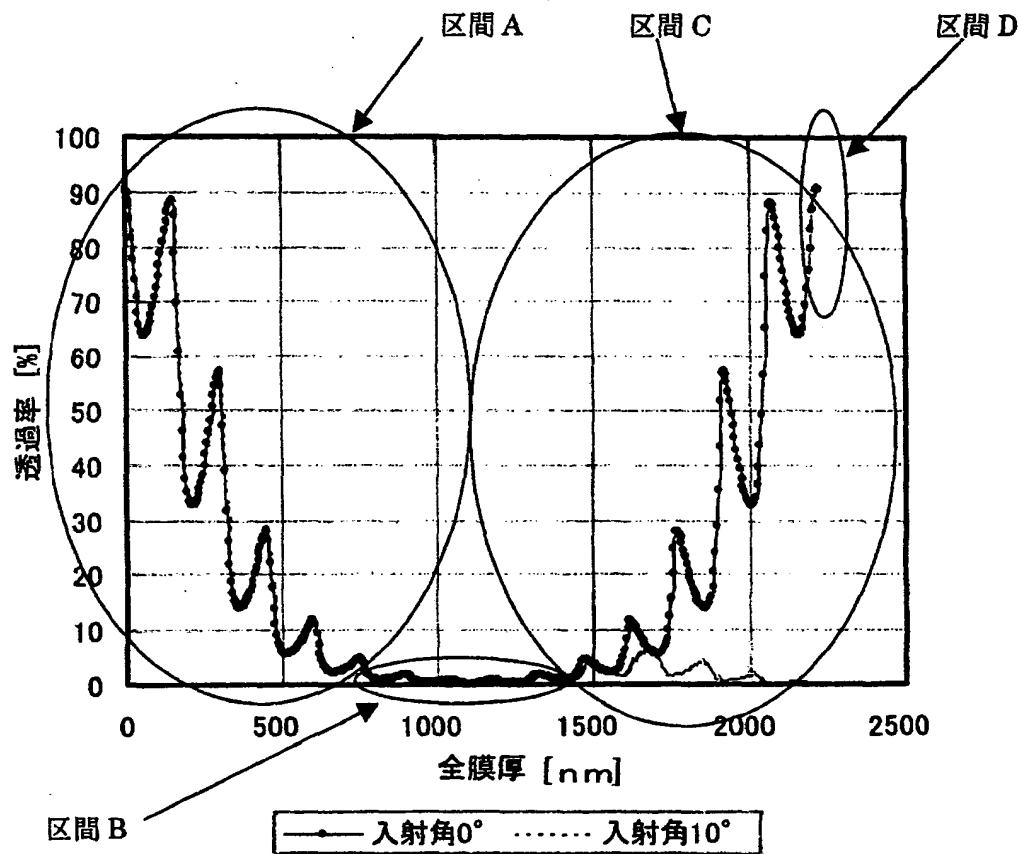


【図 20】

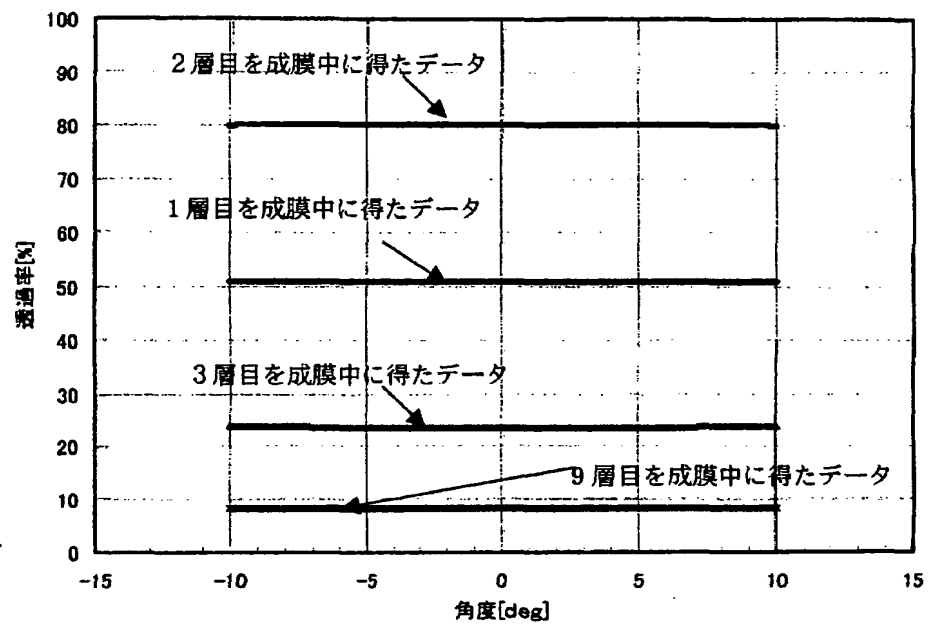
ガラス基板上にTiO₂($n=2.4$)成膜時の波長550nm光透過率変化



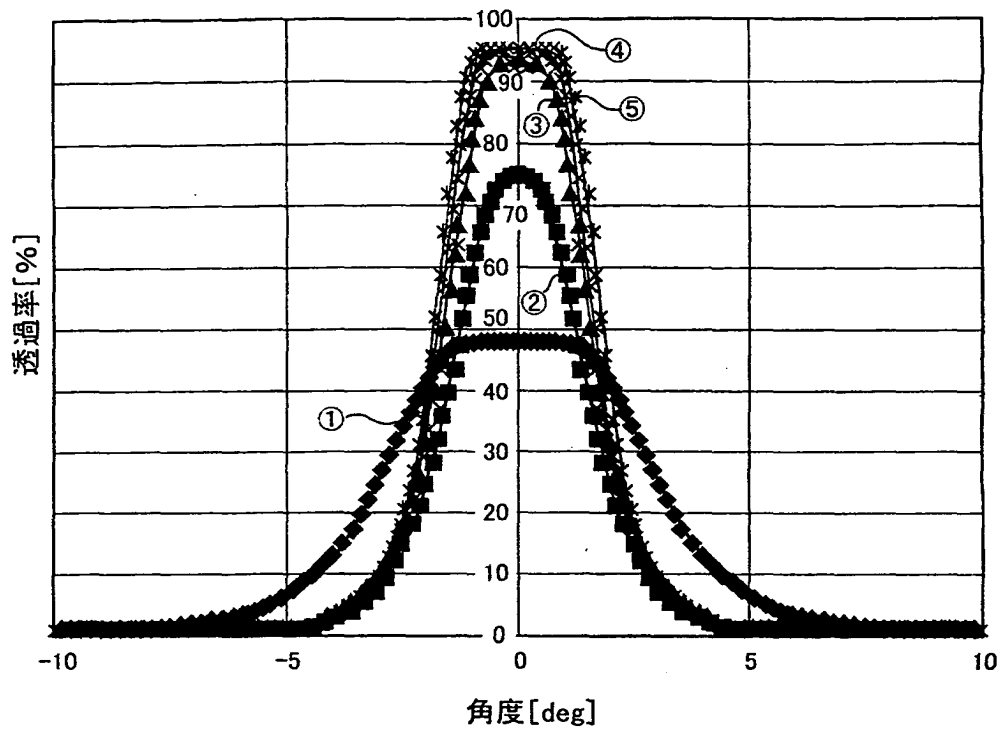
【図 21】



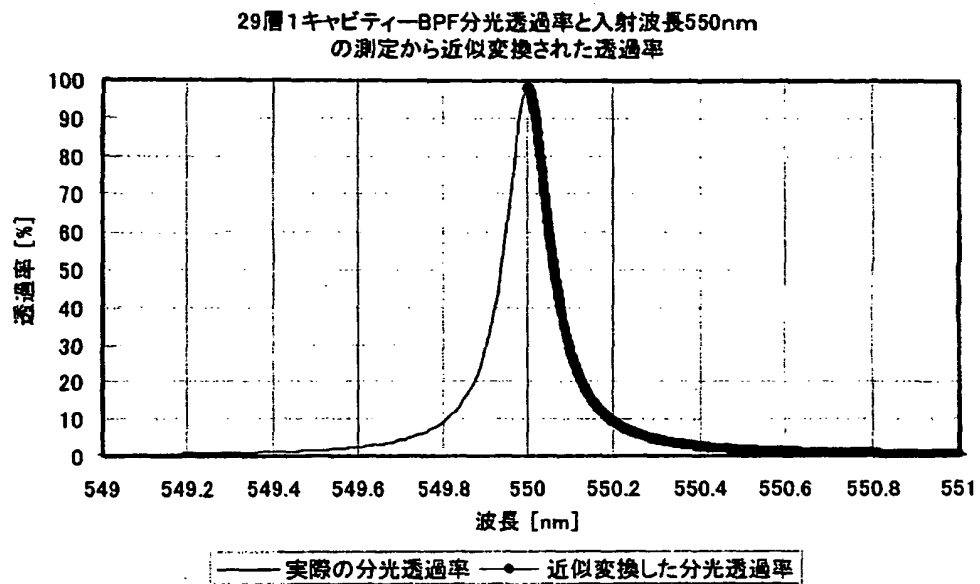
【図 22】



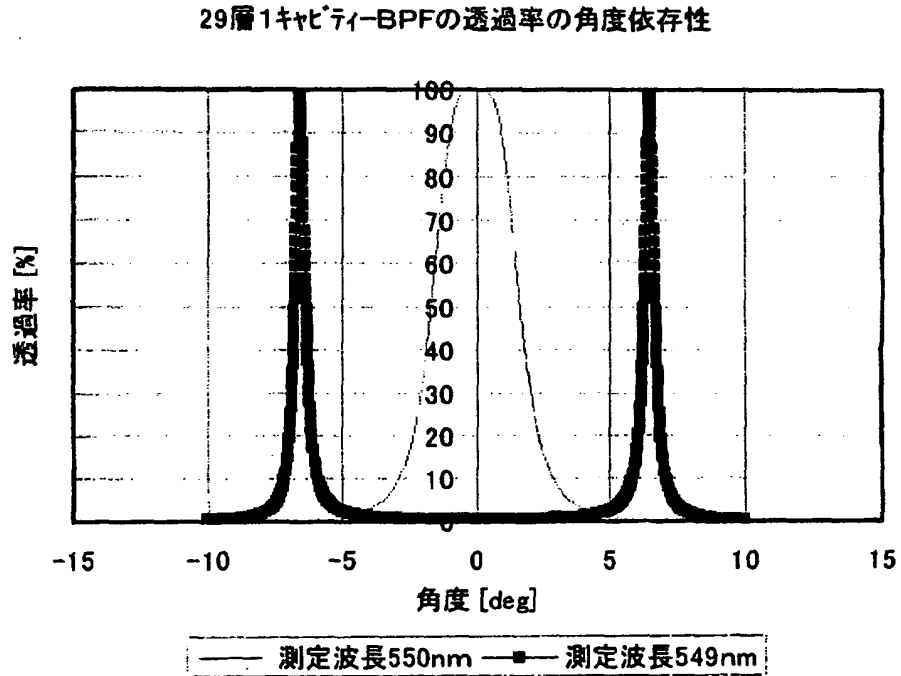
【図 23】



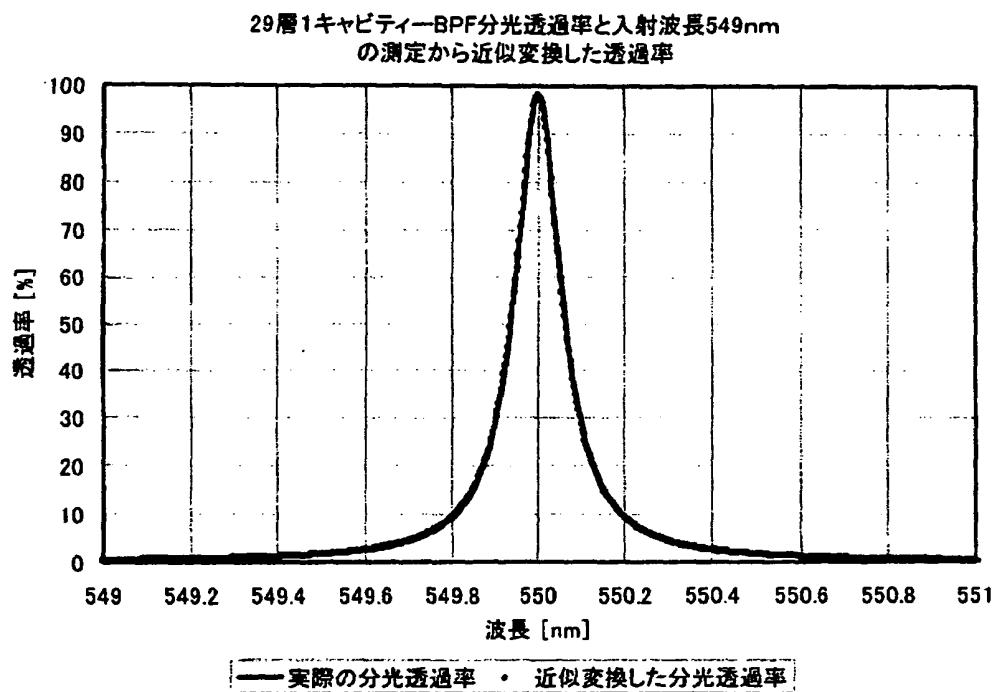
【図 2 4】



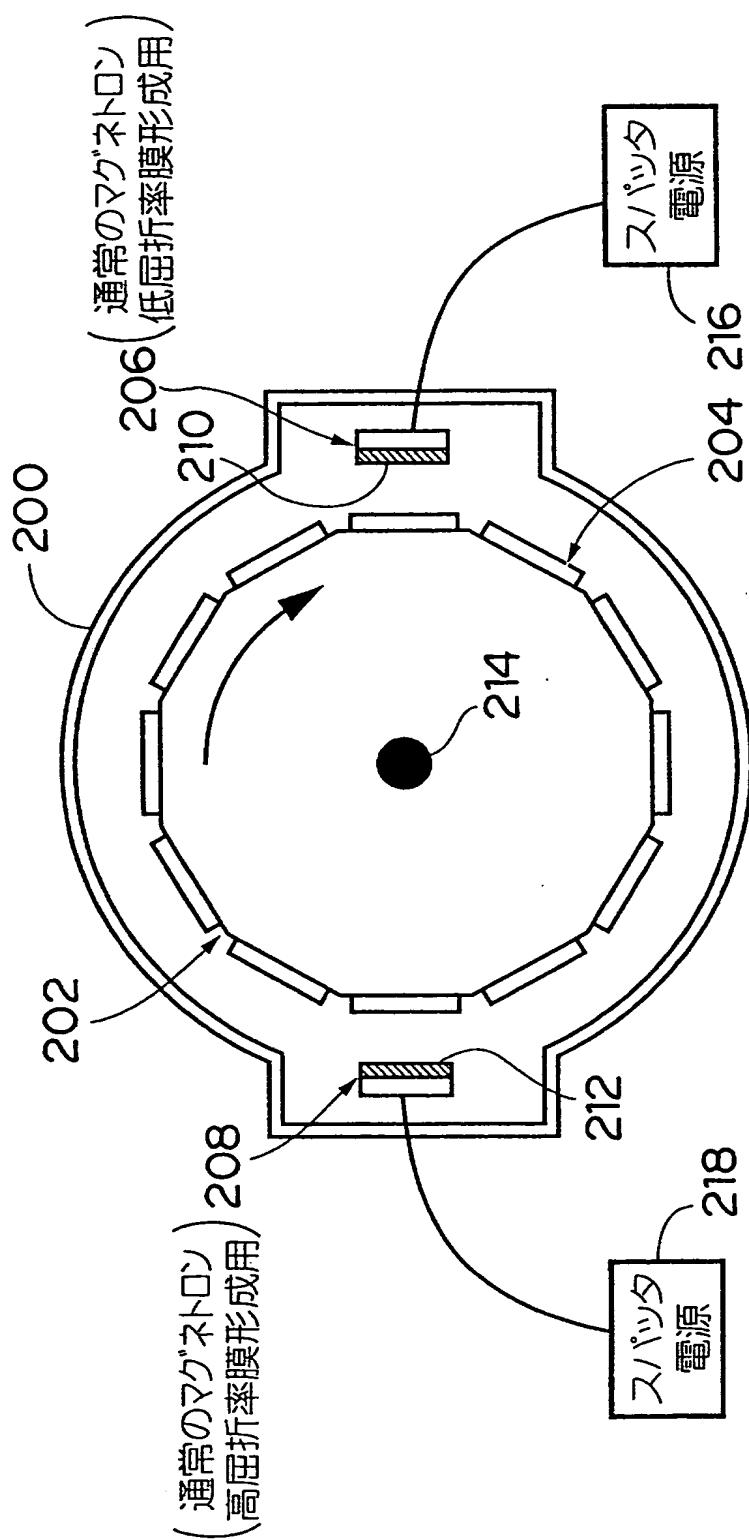
【図 2 5】



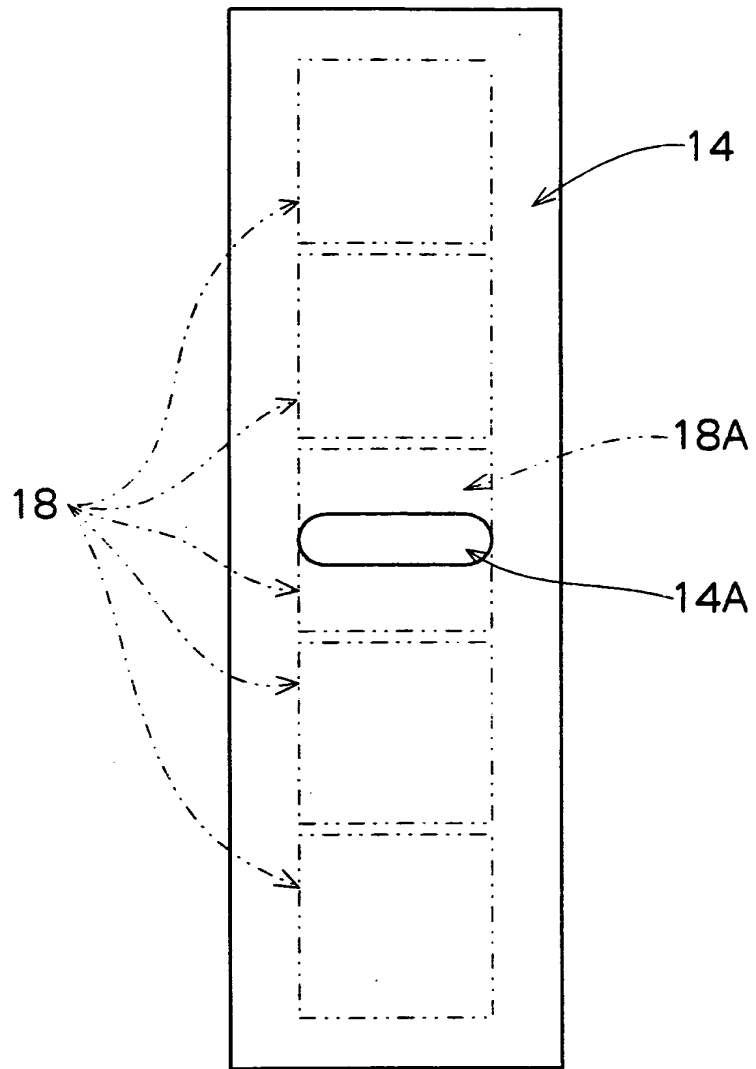
【図 26】



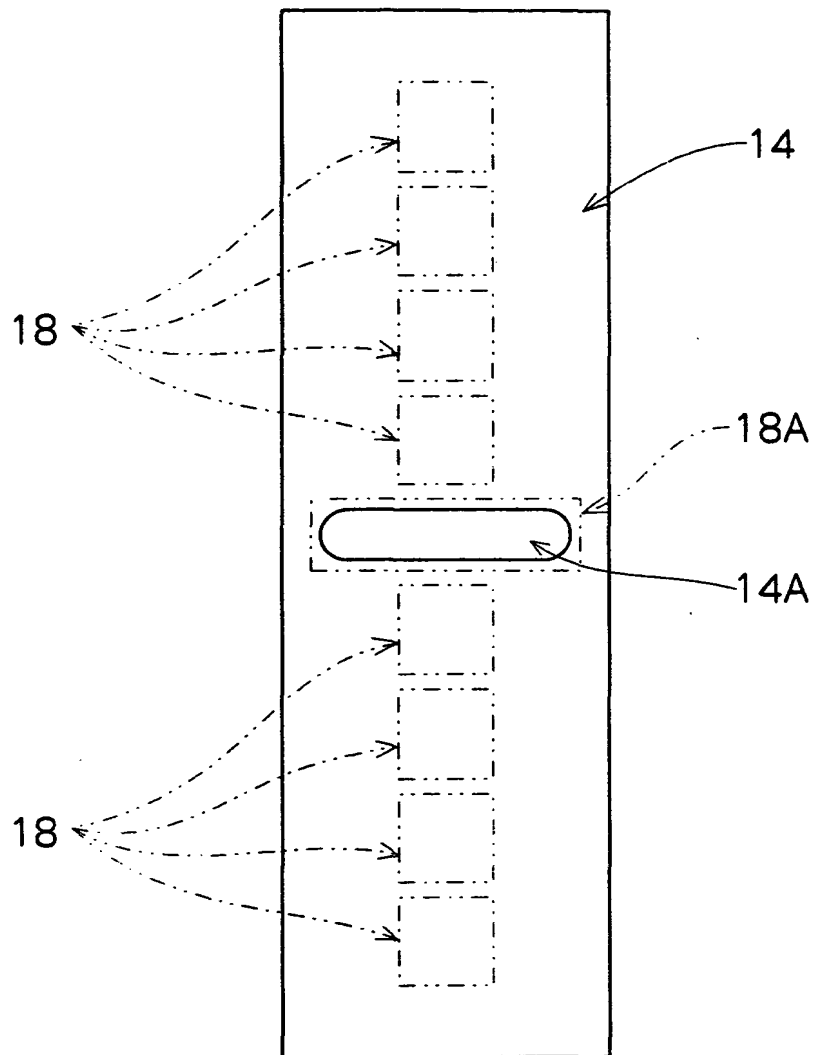
【図 27】



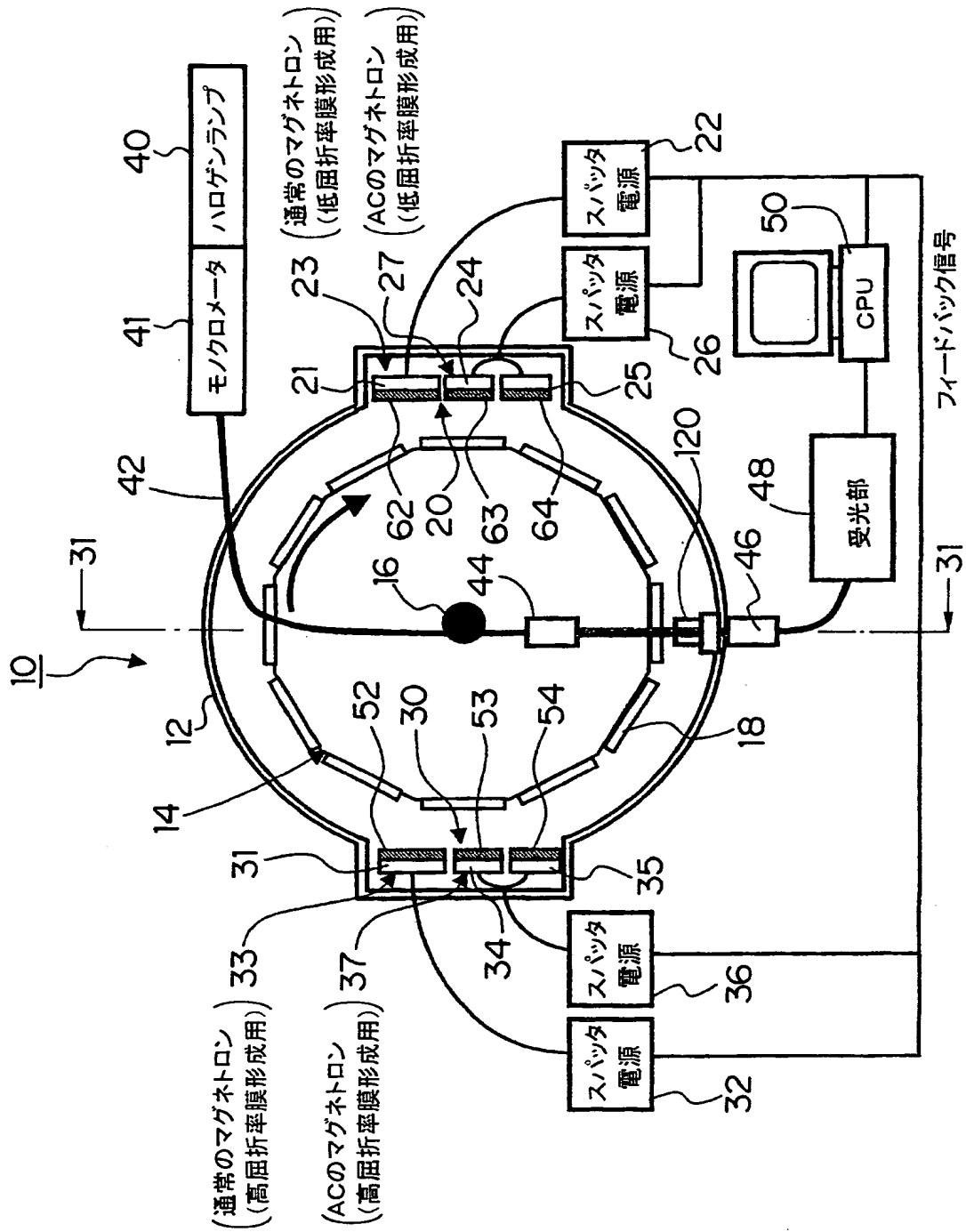
【図 2 8】



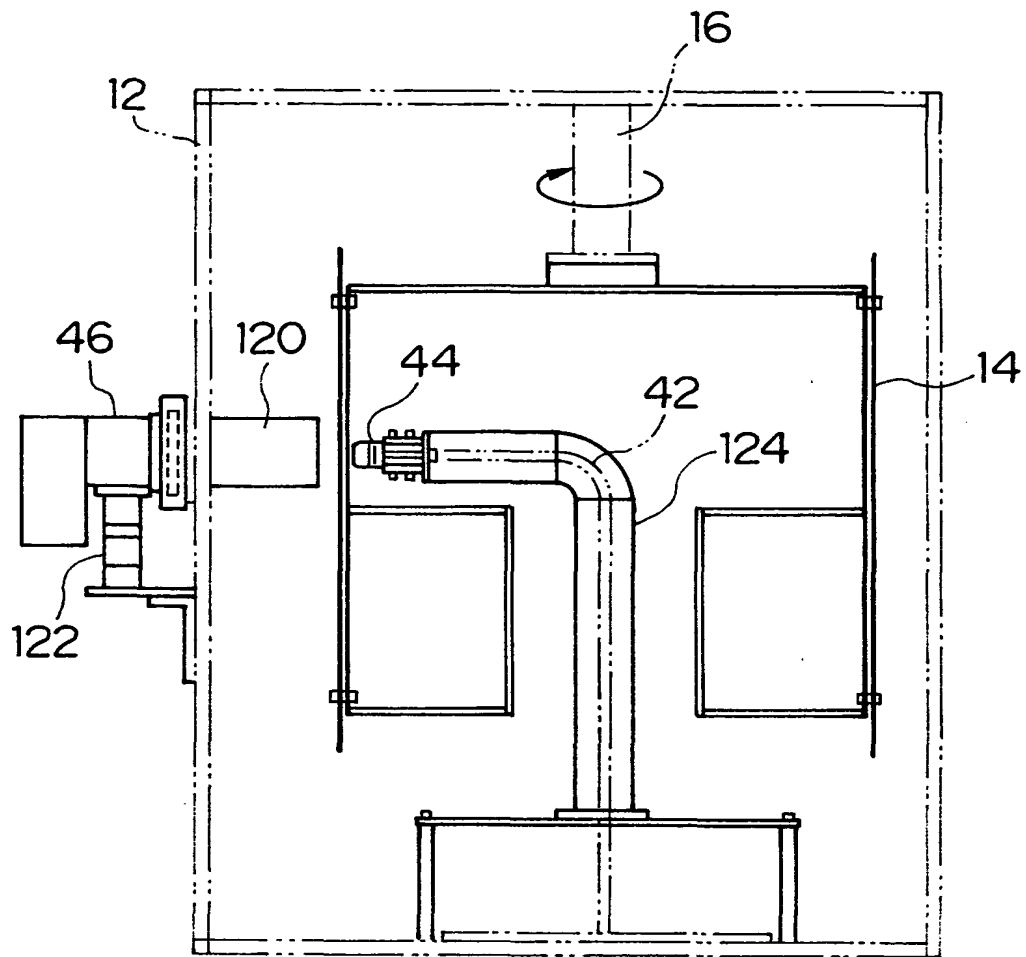
【図29】



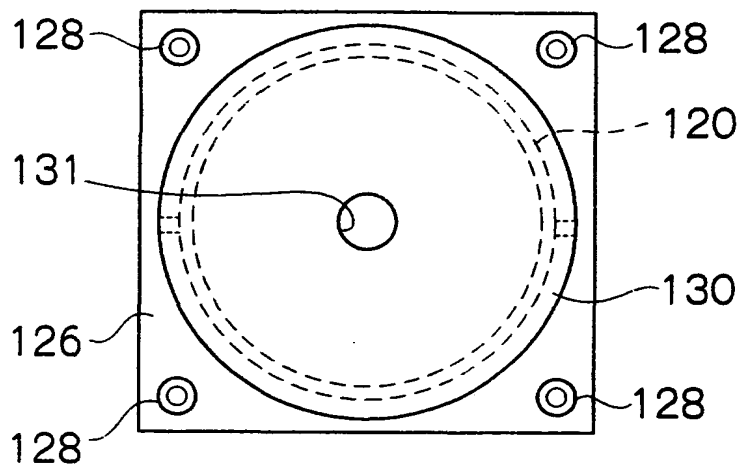
【図30】



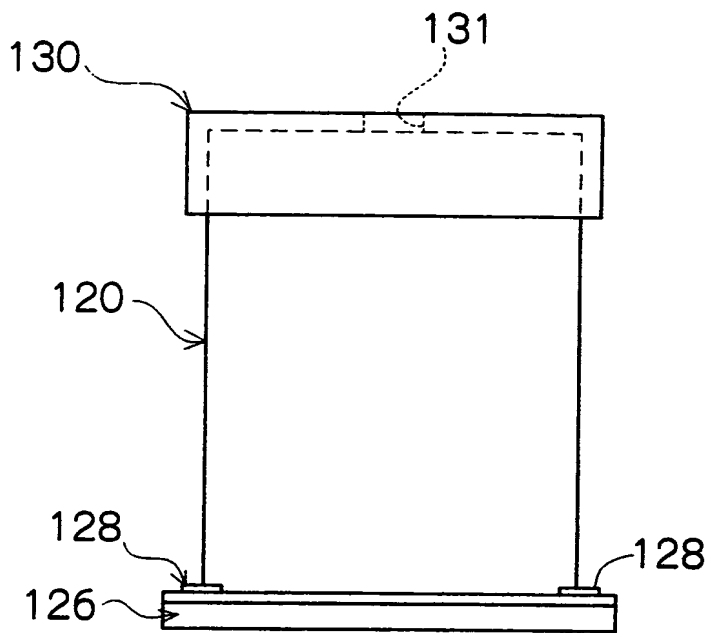
【図 3 1】



【図 3 2】



【図 3 3】

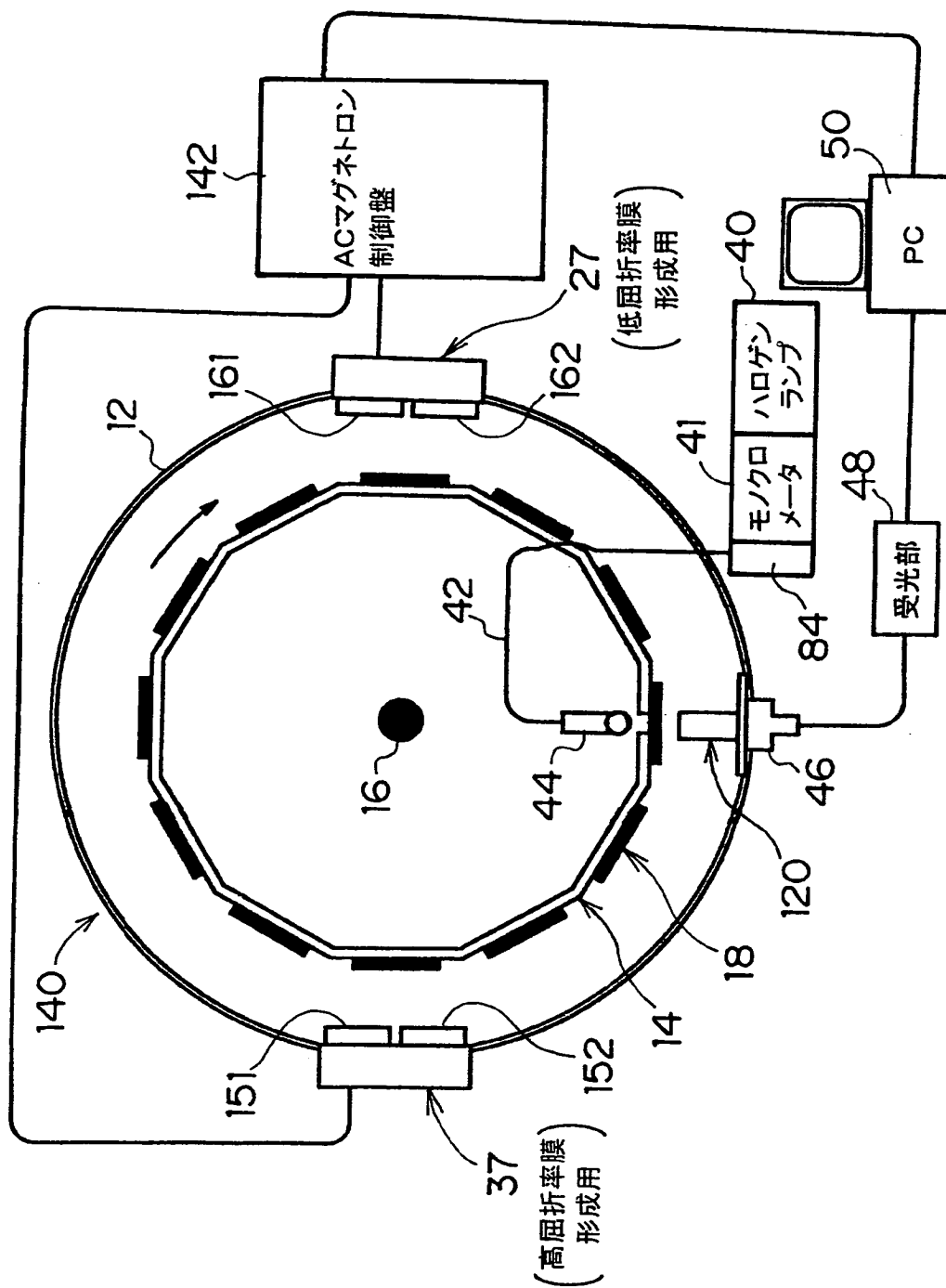


【図 34】

膜構成の概要と成膜方式

| 成膜方式 | 膜の種類 | 膜層数 | 全膜厚(目安) | 必要とされる膜厚精度 | 基板ホルダー回転数(rpm) | 用途 |
|---------------------------|---|----------|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| AC(高速)方式 | 反射防止膜 | 1~4層(片面) | 0.1~0.3 μ m | 1~5%以下 | | 各種カメラ デイスプレー等 |
| | 赤外線反射膜 紫外線反射膜 紫外線・赤外線反射膜 可視光反射膜 偏光分離膜 | 15~50層 | 1.5~4.0 μ m | 1%以下 | 8~60rpm | 照明器具 プロジェクター 各種カメラ デイスプレー等 |
| AC(高速)+ DC(低速)併用 方式 | バンドパスフィルタ | 100~200層 | 25~35 μ m | 0.01%以下 | | |
| | ゲインフラット ニングフィルタ | 30~40層 | 20~25 μ m | 0.01%以下 | 4~20rpm | WDM通信用 |

【図 35】



【図 3 6】

膜特性の評価結果

| | ACスパッタ 10層2.0 μm | DCスパッタ 26層3.0 μm | 蒸着品 34層4 μm |
|---|--|---|---------------------------|
| 成膜速度(SiO_2) (Ta_2O_5) | 42nm \cdot m/min 52nm \cdot m/min | 11nm \cdot m/min 6nm \cdot m/min | — |
| 膜応力(SiO_2) (Ta_2O_5) | -218MPa -78MPa | -67MPa -217MPa | — |
| 屈折率(SiO_2) (Ta_2O_5) | 1.472 at 550nm 2.17 at 550nm | 1.460 at 550nm 2.10 at 550nm | — |
| 消衰係数(SiO_2) (Ta_2O_5) | $<10^{-4}$ $<10^{-4}$ | $<10^{-4}$ $<10^{-4}$ | — |
| ヘーズ値 | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 平滑性(Ra) | 0.32nm | 3.0nm | 2.22nm |
| 波長シフト (60°C,90%RH,120h) | $<1\text{nm}$ | $<1\text{nm}$ | $\sim 2\text{nm}$ |

(成膜速度、膜応力、屈折率、消衰係数については単膜500nmの結果)

【図 3 7】

光学多層膜に要求される膜特性

| | 目標値 |
|---|------------------------------|
| 膜応力(SiO_2) (Ta_2O_5) | $\pm 300\text{MPa}$ 以内 |
| 屈折率(SiO_2) (Ta_2O_5) | 1.45以上1.48以下 2.15以上2.25以下 |
| 消衰係数(SiO_2) (Ta_2O_5) | $<10^{-4}$ $<10^{-4}$ |
| ヘーズ値 | $<0.1\%$ |
| 平滑性(Ra) | $<1.0\text{nm}$ |
| 波長シフト (60°C,90%RH,120h) | $<1\text{nm}$ |

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 WDM（多重波長分割）用フィルターの製造に好適で、膜厚を高精度で制御でき、かつ生産性に優れるスパッタ装置及びスパッタ成膜方法を提供する。

【解決手段】 チャンバー 1 2 内に基板ホルダー 1 4 が設置されたカルーセル型スパッタ装置において、低屈折率膜形成用と高屈折率膜形成用にそれぞれ通常のマグネトロン 2 3、3 3 と AC のマグネトロン 2 7、3 7 が併設される。設計膜厚の 9 0 % まで AC のマグネトロンのみで成膜し、その後、通常のマグネトロンのみで成膜する。成膜中に基板 1 8 の透過率を測定し、その情報を電源にフィードバックすることで、膜厚コントロールを行う。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000044]

1. 変更年月日 1999年12月14日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
氏 名 旭硝子株式会社